

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Takashi YAMADA, et al.

GAU:

SERIAL NO: New Application

EXAMINER:

FILED: Herewith

FOR: SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

REQUEST FOR PRIORITY

COMMISSIONER FOR PATENTS
ALEXANDRIA, VIRGINIA 22313

SIR:

- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number _____, filed _____, is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §120.
- ☐ Full benefit of the filing date(s) of U.S. Provisional Application(s) is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119(e):
Application No. _____ Date Filed _____

- ☒ Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:

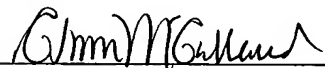
<u>COUNTRY</u>	<u>APPLICATION NUMBER</u>	<u>MONTH/DAY/YEAR</u>
Japan	2003-209311	August 28, 2003

Certified copies of the corresponding Convention Application(s)

- ☒ are submitted herewith
- ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee
- ☐ were filed in prior application Serial No. _____ filed _____
- ☐ were submitted to the International Bureau in PCT Application Number _____
Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.
- ☐ (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. _____ filed _____; and
- ☐ (B) Application Serial No.(s) _____
☐ are submitted herewith
- ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.



Marvin J. Spivak

Registration No. 24,913

C. Irvin McClelland
Registration Number 21,124

Customer Number

22850

Tel. (703) 413-3000
Fax. (703) 413-2220
(OSMMN 05/03)

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 8 月 2 8 日
Date of Application:

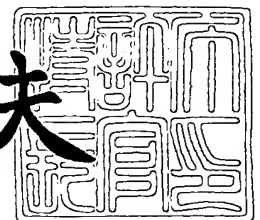
出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 2 0 9 3 1 1
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 3 - 2 0 9 3 1 1]

出 願 人 株 式 会 社 東 芝
Applicant(s):

2 0 0 3 年 9 月 1 7 日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 A000300143

【提出日】 平成15年 8月28日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H01L 21/00

【発明の名称】 半導体装置及びその製造方法

【請求項の数】 25

【発明者】

 【住所又は居所】 神奈川県横浜市磯子区新杉田町 8 番地 株式会社東芝横浜事業所内

 【氏名】 山田 敬

【発明者】

 【住所又は居所】 神奈川県横浜市磯子区新杉田町 8 番地 株式会社東芝横浜事業所内

 【氏名】 永野 元

【発明者】

 【住所又は居所】 神奈川県横浜市磯子区新杉田町 8 番地 株式会社東芝横浜事業所内

 【氏名】 浜本 毅司

【特許出願人】

 【識別番号】 000003078

 【氏名又は名称】 株式会社 東芝

【代理人】

 【識別番号】 100058479

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 鈴江 武彦

 【電話番号】 03-3502-3181

【選任した代理人】

【識別番号】 100091351

【弁理士】

【氏名又は名称】 河野 哲

【選任した代理人】

【識別番号】 100088683

【弁理士】

【氏名又は名称】 中村 誠

【選任した代理人】

【識別番号】 100108855

【弁理士】

【氏名又は名称】 蔵田 昌俊

【選任した代理人】

【識別番号】 100084618

【弁理士】

【氏名又は名称】 村松 貞男

【選任した代理人】

【識別番号】 100092196

【弁理士】

【氏名又は名称】 橋本 良郎

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011567

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 半導体装置及びその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 第 1 乃至第 4 の領域を有する基板と、
前記第 1 の領域における前記基板上に設けられた第 1 の絶縁膜と、
前記第 2 の領域における前記基板上に設けられ、前記第 1 の絶縁膜の上面よりも高い上面を有する第 1 のエピタキシャル層と、
前記第 1 のエピタキシャル層と隙間を有して前記第 1 の絶縁膜上に設けられ、前記第 1 のエピタキシャル層の前記上面とほぼ等しい高さの上面を有する第 1 の半導体層と、
前記隙間に設けられ、前記第 1 のエピタキシャル層の前記上面及び前記第 1 の半導体層の前記上面とほぼ等しい高さの上面を有する素子分離絶縁膜と
を具備することを特徴とする半導体装置。

【請求項 2】 前記第 1 の絶縁膜と前記素子分離絶縁膜とは同質の材料からなることを特徴とする請求項 1 に記載の半導体装置。

【請求項 3】 前記第 3 の領域における前記基板上に設けられた第 2 の絶縁膜と、
前記第 2 の絶縁膜上に設けられた第 2 の半導体層と、
前記第 4 の領域における前記基板上に設けられ、前記第 2 の半導体層の上面とほぼ等しい高さの上面を有し、前記第 2 の絶縁膜及び前記第 2 の半導体層に接する第 2 のエピタキシャル層と
をさらに具備することを特徴とする請求項 1 に記載の半導体装置。

【請求項 4】 第 1 及び第 2 の領域を有する基板と、
前記第 1 の領域における前記基板上に設けられた第 1 の絶縁膜と、
前記第 2 の領域における前記基板上に前記第 1 の絶縁膜と第 1 の隙間を有して設けられ、前記第 1 の絶縁膜の上面よりも高い上面を有するエピタキシャル層と、
前記第 1 の絶縁膜上に設けられた第 1 の部分と前記第 1 の絶縁膜の前記エピタキシャル層側の側面よりも突出する第 2 の部分とを有し、前記エピタキシャル層

と第2の隙間を有して設けられ、前記第1及び第2の部分の上面の高さと前記エピタキシャル層の前記上面の高さとがほぼ等しい半導体層と、

前記第1及び第2の隙間に設けられ、前記エピタキシャル層の前記上面及び前記第1及び第2の部分の前記上面とほぼ等しい高さの上面を有する素子分離絶縁膜と

を具備することを特徴とする半導体装置。

【請求項5】 第1及び第2の領域を有する基板と、

前記第1の領域における前記基板上に設けられた第1の絶縁膜と、

前記第2の領域における前記基板上に前記第1の絶縁膜と第1の隙間を有して設けられ、前記第1の絶縁膜の上面よりも高い上面を有するエピタキシャル層と

前記第1の絶縁膜上に前記第1の隙間よりも前記エピタキシャル層と離間する第2の隙間を有して設けられ、前記エピタキシャル層の前記上面の高さとほぼ等しい上面を有する半導体層と、

前記第1及び第2の隙間に設けられ、前記エピタキシャル層の前記上面及び前記半導体層の前記上面とほぼ等しい高さの上面を有する素子分離絶縁膜と

を具備することを特徴とする半導体装置。

【請求項6】 前記素子分離絶縁膜は、シリコン窒化膜で形成されていることを特徴とする請求項4又は5に記載の半導体装置。

【請求項7】 第1及び第2の領域を有する基板と、

前記第1の領域における前記基板上に設けられた第1の絶縁膜と、

前記第1の絶縁膜上に設けられた半導体層と、

前記半導体層上に設けられた第1のゲート絶縁膜と、

前記第1のゲート絶縁膜上に選択的に設けられ、第1の電極層と第2の電極層とを有する第1のゲート電極と、

前記第2の領域における前記基板上に設けられた第2のゲート絶縁膜と、

前記第2のゲート絶縁膜上に選択的に設けられ、第3の電極層と第4の電極層とを有し、前記第1のゲート電極の上面とほぼ等しい高さを有する第2のゲート電極と、

前記第 1 及び第 2 の領域の境界部分に設けられた素子分離絶縁膜とを具備することを特徴とする半導体装置。

【請求項 8】 第 1 及び第 2 の領域を有する基板と、

前記第 1 及び第 2 の領域の境界部分に設けられ、前記基板より一部が突出する第 1 の素子分離絶縁膜と、

前記第 2 の領域内に設けられ、前記基板より一部が突出する第 2 の素子分離絶縁膜と、

前記第 1 の領域における前記基板上に設けられた第 1 の絶縁膜と、

前記第 1 の絶縁膜上に設けられた半導体層と、

前記半導体層上に設けられた第 1 のゲート絶縁膜と、

前記第 1 のゲート絶縁膜上に選択的に設けられ、第 1 の電極層と第 2 の電極層とを有する第 1 のゲート電極と、

前記第 1 及び第 2 の素子分離絶縁膜間の前記基板上に設けられた第 2 のゲート絶縁膜と、

前記第 2 のゲート絶縁膜上に設けられ、第 3 の電極層とこの第 3 の電極層上に設けられた第 2 の絶縁膜とこの第 2 の絶縁膜上に設けられた第 4 の電極層とを有し、前記第 1 のゲート電極の上面とほぼ等しい高さを有する第 2 のゲート電極とを具備し、

前記第 3 の電極層は凹形状の連続する第 1 乃至第 3 の部分を有し、前記第 1 の部分は前記第 2 のゲート絶縁膜上に形成されており、前記第 2 の部分は前記第 1 の素子分離絶縁膜の側面に沿って形成されており、前記第 3 の部分は前記第 2 の素子分離絶縁膜の側面に沿って形成されており、

前記第 2 の絶縁膜は連続する第 4 乃至第 8 の部分を有し、前記第 4 の部分は前記第 1 の部分上に形成されており、前記第 5 の部分は前記第 2 の部分上に形成されており、前記第 6 の部分は前記第 3 の部分上に形成されており、前記第 7 の部分は前記第 2 の部分及び前記第 1 の素子分離絶縁膜上に形成されており、前記第 8 の部分は前記第 3 の部分及び前記第 2 の素子分離絶縁膜上に形成されていることを特徴とする半導体装置。

【請求項 9】 第 1 乃至第 3 の領域を有する基板と、

前記第 1 の領域における前記基板上に設けられ、第 1 の材料膜で形成された第 1 の絶縁膜と、

前記第 1 の絶縁膜上に設けられ、第 2 の材料膜で形成された半導体層と、

前記半導体層上に設けられ、第 3 の材料膜で形成された第 1 のゲート絶縁膜と

、
前記第 1 のゲート絶縁膜上に選択的に設けられ、第 4 の材料膜で形成された第 1 のゲート電極と、

前記第 2 の領域における前記基板上に設けられ、前記第 1 の材料膜で形成された第 2 のゲート絶縁膜と、

前記第 2 のゲート絶縁膜上に選択的に設けられ、前記第 2 の材料膜で形成された第 1 の電極層と前記第 4 の材料膜で形成された第 2 の電極層とを有し、前記第 1 のゲート電極の上面とほぼ等しい高さを有する第 2 のゲート電極と、

前記第 1 及び第 2 の領域の境界部分に設けられた第 1 の素子分離絶縁膜とを具備することを特徴とする半導体装置。

【請求項 10】 前記第 1 の電極層は、単結晶シリコン層で形成されていることを特徴とする請求項 9 に記載の半導体装置。

【請求項 11】 前記第 3 の領域における前記基板上に設けられ、前記第 1 の材料膜で形成された前記第 3 のゲート絶縁膜と、

前記第 3 のゲート絶縁膜上に設けられ、前記第 2 の材料膜で形成された第 3 の電極層と前記第 3 の材料膜で形成された第 2 の絶縁膜と前記第 4 の材料膜で形成された第 4 の電極層とを有し、前記第 1 及び第 2 のゲート電極の上面とほぼ等しい高さを有する第 3 のゲート電極と、

前記第 2 及び第 3 の領域の境界部分に設けられた第 2 の素子分離絶縁膜とをさらに具備することを特徴とする請求項 9 に記載の半導体装置。

【請求項 12】 基板とこの基板上に設けられた第 1 の絶縁膜とこの第 1 の絶縁膜上に設けられた半導体層とからなり、第 1 乃至第 4 の領域を有するウエハを形成する工程と、

前記第 1 の領域の前記半導体層上に第 2 の絶縁膜を形成する工程と、

前記第 2 の絶縁膜をマスクとして、前記第 2 の領域の前記半導体層及び前記第

1 の絶縁膜を除去する工程と、

前記第 1 の領域において、前記半導体層の前記第 2 の領域側の側面を前記第 1 の絶縁膜の側面よりも後退させて隙間部を形成する工程と、

前記隙間部に第 1 の素子分離絶縁膜を形成する工程と、

前記第 2 の領域において、エピタキシャル成長により前記半導体層の上面とほぼ等しくなるまでエピタキシャル層を前記基板上に形成する工程と、

前記第 2 の絶縁膜を除去する工程と、

前記第 1 の領域の前記半導体層上に第 1 のゲート絶縁膜を介して第 1 のゲート電極を形成するとともに、前記第 2 の領域の前記エピタキシャル層上に第 2 のゲート絶縁膜を介して第 2 のゲート電極を形成する工程と

を具備することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 1 3】 前記第 2 の領域の前記半導体層及び前記第 1 の絶縁膜を除去する際に前記第 1 の絶縁膜を薄く残存させ、この残存させた前記第 1 の絶縁膜は前記エピタキシャル成長前に除去することを特徴とする請求項 1 2 に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 1 4】 前記第 1 の素子分離絶縁膜は、前記第 1 の絶縁膜と同質の材料で形成することを特徴とする請求項 1 2 に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 1 5】 前記第 2 の絶縁膜は、シリコン酸化膜であることを特徴とする請求項 1 2 に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 1 6】 前記第 2 の絶縁膜を形成する際、前記第 3 の領域の前記半導体層上に第 3 の絶縁膜を形成し、

前記第 2 の領域の前記半導体層及び前記第 1 の絶縁膜を除去する際に、前記第 3 の絶縁膜をマスクとして、前記第 4 の領域の前記半導体層及び前記第 1 の絶縁膜を除去し、

前記隙間部を形成する前に、前記第 3 の領域の前記半導体層の前記第 4 の領域側の側面をマスクで覆い、

前記隙間部を形成した後に、前記マスクを除去する

ことを特徴とする請求項 1 2 に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 1 7】 前記エピタキシャル成長の際、前記第 1 及び第 2 の領域の

境界部分の前記エピタキシャル層にファセットが生じた場合、前記ファセットを除去するように第2の素子分離絶縁膜を形成する工程をさらに具備することを特徴とする請求項12に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項18】 基板とこの基板上に設けられた第1の絶縁膜とこの第1の絶縁膜上に設けられた半導体層とからなり、第1及び第2の領域を有するウエハを形成する工程と、

前記第1の領域の前記半導体層上に第2の絶縁膜を形成する工程と、

前記第2の絶縁膜をマスクとして、前記第2の領域の前記半導体層及び前記第1の絶縁膜を除去する工程と、

前記第1の領域において、前記半導体層の前記第2の領域側の側面を前記第2の絶縁膜の側面よりも後退させて第1の隙間部を形成する工程と、

前記第1の領域において、前記第1の絶縁膜の前記第2の領域側の側面を前記第2の絶縁膜の側面よりも後退させて第2の隙間部を形成する工程と、

前記第1及び第2の隙間部に素子分離絶縁膜を形成する工程と、

前記第2の領域において、エピタキシャル成長により前記半導体層の上面とはほぼ等しくなるまでエピタキシャル層を前記基板上に形成する工程と、

前記第2の絶縁膜を除去する工程と、

前記第1の領域の前記半導体層上に第1のゲート絶縁膜を介して第1のゲート電極を形成するとともに、前記第2の領域の前記エピタキシャル層上に第2のゲート絶縁膜を介して第2のゲート電極を形成する工程と

を具備することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項19】 前記素子分離絶縁膜は、シリコン窒化膜で形成されていることを特徴とする請求項18に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項20】 前記第1の隙間部の幅は、前記第2の隙間部の幅より小さいことを特徴とする請求項18に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項21】 前記第2の隙間部の幅は、前記第1の隙間部の幅より小さいことを特徴とする請求項18に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項22】 基板とこの基板上に設けられた第1の絶縁膜とこの第1の絶縁膜上に設けられた半導体層とからなり、第1及び第2の領域を有するウエハ

を形成する工程と、

前記第 1 及び第 2 の領域の境界部分に、前記半導体層の上面よりも一部が突出するように素子分離絶縁膜を形成する工程と、

前記第 2 の領域の前記第 1 の絶縁膜及び前記半導体層を除去する工程と、

前記第 1 の領域の前記半導体層上に第 1 のゲート絶縁膜を形成するとともに、前記第 2 の領域の前記基板上に第 2 のゲート絶縁膜を形成する工程と、

前記素子分離絶縁膜、前記第 1 及び第 2 のゲート絶縁膜上に第 1 の電極材を形成し、この第 1 の電極材を前記素子分離絶縁膜の上面が露出するまで平坦化する工程と、

前記第 1 の電極材及び前記素子分離絶縁膜上に第 2 の電極材を形成する工程と、

前記第 1 及び第 2 の電極材を一括加工することによって、前記第 1 の領域においては、前記第 1 の電極材からなる第 1 の電極層と前記第 2 の電極材からなる第 2 の電極層とを有する第 1 のゲート電極を形成するとともに、前記第 2 の領域においては、前記第 1 の電極材からなる第 3 の電極層と前記第 2 の電極材からなる第 4 の電極層とを有し、前記第 1 のゲート電極の上面とほぼ等しい高さを有する第 2 のゲート電極を形成する工程と

を具備することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 2 3】 前記第 2 の領域において、前記第 1 及び第 2 の電極材間に第 2 の絶縁膜を形成する工程をさらに具備することを特徴とする請求項 2 2 に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 2 4】 第 1 乃至第 3 の領域を有する基板を形成する工程と、
前記基板上に第 1 の材料膜を形成する工程と、
前記第 1 の材料膜上に第 2 の材料膜を形成する工程と、
前記第 1 及び第 2 の領域の境界部分に素子分離絶縁膜を形成し、前記第 2 の領域の前記第 1 の材料膜からなる第 2 のゲート絶縁膜を形成する工程と、
前記第 1 の領域の前記第 2 の材料膜上に第 3 の材料膜からなる第 1 のゲート絶縁膜を形成する工程と、

前記第 1 のゲート絶縁膜、前記第 2 の領域における前記第 2 の材料膜及び前記

素子分離絶縁膜上に第 4 の材料膜を形成する工程と、

前記第 1 の領域における前記第 4 の材料膜、前記第 2 の領域における前記第 2 及び第 4 の材料膜を一括加工し、前記第 1 の領域においては、前記第 4 の材料膜からなる第 1 のゲート電極を形成し、前記第 2 の領域においては、前記第 2 の材料膜からなる第 1 の電極層と前記第 4 の材料膜からなる第 2 の電極層とを有し、前記第 1 のゲート電極の上面とほぼ等しい高さを有する第 2 のゲート電極を形成する工程と

を具備することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 2 5】 前記第 3 の領域において、

前記基板上に前記第 1 の材料膜からなる第 3 のゲート絶縁膜を形成し、

前記第 3 のゲート絶縁膜上に、前記第 2 の材料膜からなる第 3 の電極層と前記第 3 の材料膜からなる第 2 の絶縁膜と前記第 4 の材料膜からなる第 4 の電極層とを有する第 3 のゲート電極を形成する

ことを特徴とする請求項 2 4 に記載の半導体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、S O I (Silicon On Insulator) 領域とバルク領域とを有するハイブリッドウエハを用いた半導体装置及びその製造方法に関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

近年、従来のシリコンウエハの代わりに薄膜 S O I (Silicon On Insulator) ウエハを用い、この S O I ウエハ上に素子を形成することで、寄生容量を低減し、ロジック回路の低消費電力化や高速化を図る試みが盛んに検討されており、さらに、S O I ウエハを用いたマイクロプロセッサの製品化も始まっている。今後は、このような S O I ロジックを核にしたシステム L S I チップの必要性が高まるものと予想される。

【0 0 0 3】

しかしながら、S O I ウエハ上の M O S F E T はチャネルが形成されるボディ

領域の電位がフローティング状態となるため、いわゆる基板浮遊効果により、回路動作に伴うリーク電流の発生やしきい値の変動が生ずる。このため、SOIウエハは、DRAMのセルトランジスタ、センスアンプ回路やアナログ回路のペアトランジスタなどのように、リーク電流レベルあるいはマッチング特性に対するスペックが厳しい回路へ適用するには不向きであった。

【0004】

この問題を解決するために、SOIウエハ上にバルク領域を形成したハイブリッドウエハを用意し、DRAMのようなSOIウエハには向かない回路はバルク領域へ形成する提案がある。具体的には、例えば次のような方法がある。

【0005】

第1に、マスクパターンを用いたSIMOX (Separation by IMplantation of Oxygen) 法により、バルクウエハ上に選択的にSOI領域を形成する方法がある(特許文献1、非特許文献1参照)。

【0006】

第2に、絶縁膜をパターンニングしたバルクウエハ上に別のウエハを張り合わせる方法がある(特許文献2参照)。

【0007】

第3に、SOIウエハ上のSOI層と埋め込み絶縁膜とを部分的にエッチング除去する方法がある(特許文献3、特許文献4、特許文献5参照)。

【0008】

第4に、上記第3の方法において、SOI領域とバルク領域との間に生じた段差を解消するために、バルク領域の支持基板上にシリコンなどを選択エピタキシャル成長し、あるいはさらに研磨によって平坦化する方法がある(特許文献6、非特許文献2参照)。

【0009】

このようなハイブリッドウエハを用いた種々の方法において、第4の方法は、SOI領域の素子表面とバルク領域の素子表面との段差が無いことから、素子の生産性に優れている。さらに出来合いのSOIウエハをもとに製造するため、SOI層や埋め込み絶縁膜の膜厚構成、さらにはシリコン層やSiGe層などSO

I 層の材質などが変化しても柔軟に対応できる手法である。

【 0 0 1 0 】

【特許文献 1】

特開平10-303385号公報

【 0 0 1 1 】

【特許文献 2】

特開平8-316431号公報

【 0 0 1 2 】

【特許文献 3】

特開平7-106434号公報

【 0 0 1 3 】

【特許文献 4】

特開平11-238860号公報

【 0 0 1 4 】

【特許文献 5】

特開2000-91534号公報

【 0 0 1 5 】

【特許文献 6】

特開2000-243944号公報

【 0 0 1 6 】

【非特許文献 1】

Robert Hannon, et al., 2000 Symposium on VLSI Technology of Technical Papers, pp.66-67

【 0 0 1 7 】

【非特許文献 2】

T. Yamada, et al., 2002 Symposium on VLSI Technology of Technical Papers, pp.112-113

【 0 0 1 8 】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記従来の第4の方法では次のような問題があった。この問題を説明するにあたり、具体的に第4の方法を以下に説明する。

【0019】

まず、図41に示すように、支持基板111と埋め込み絶縁膜112とSOI層113とを有するSOIウエハが用意される。

【0020】

次に、図42に示すように、SOI層113上に保護のための第1のマスク材（例えばSiN膜）114が堆積される。次に、バルク領域における第1のマスク材114、SOI層113、埋め込み絶縁膜112が順に、選択的にエッチング除去される。この際、支持基板111上に薄い埋め込み絶縁膜112'を残す。

【0021】

次に、図43に示すように、全面にSOI層113の側壁保護用の第2のマスク材（例えばSiN膜）116が堆積される。その後、異方性ドライエッチングにより、SOI層113の側面に第2のマスク材116からなるスペーサが形成される。この際、上記図42の工程と同様に、支持基板111上の薄い埋め込み絶縁膜112''を残すようにする。

【0022】

次に、図44に示すように、支持基板111へダメージを与えないように、HF溶液などを用いて埋め込み絶縁膜112、112''を除去する。尚、SOI層113の上部及び側面におけるマスク材114、116は、埋め込み絶縁膜112と異なる種類の絶縁膜であるため、埋め込み絶縁膜112、112''を除去してもマスク材114、115を残すことが可能となる。

【0023】

次に、図45に示すように、露出した支持基板111上に、単結晶シリコンなどの素子形成用膜として、エピタキシャル成長技術によるエピタキシャル層117が形成される。このエピタキシャル成長では、エピタキシャル層117の上面がSOI層113の上面とほぼ一致するように、両者の高さ合わせを行う。尚、エピタキシャル層117のSOI領域側の上端部には、ファセット161が生じ

る。

【0024】

次に、図46に示すように、第1のマスク材114が除去される。このとき、SOI層113の側面に形成された第2のマスク材116は第1のマスク材114と同じ材料で形成されているため、第1のマスク材114とともに第2のマスク材116も除去され、SOI領域とバルク領域との境界部に窪み160が生じてしまう。

【0025】

次に、図47に示すように、ゲート絶縁膜120、121、ゲート電極122、123、131、STI (Shallow Trench Isolation) 構造の素子分離領域118、119、130がそれぞれ形成される。

【0026】

上記のような従来の第4の方法では、SOI領域とバルク領域との境界部のファセット161や窪み160が生じてしまう。従って、これらファセット161や窪み160を無くすために、SOI領域とバルク領域との境界部における素子分離領域130のスペースが大きくなってしまっていた。

【0027】

本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところは、SOI領域とバルク領域との境界部における素子分離領域のスペースを縮小することが可能な半導体装置及びその製造方法を提供することにある。

【0028】

【課題を解決するための手段】

本発明は、前記目的を達成するために以下に示す手段を用いている。

【0029】

本発明の第1の視点による半導体装置は、第1乃至第4の領域を有する基板と、前記第1の領域における前記基板上に設けられた第1の絶縁膜と、前記第2の領域における前記基板上に設けられ、前記第1の絶縁膜の上面よりも高い上面を有する第1のエピタキシャル層と、前記第1のエピタキシャル層と隙間を有して前記第1の絶縁膜上に設けられ、前記第1のエピタキシャル層の前記上面とほぼ

等しい高さの上面を有する第1の半導体層と、前記隙間に設けられ、前記第1のエピタキシャル層の前記上面及び前記第1の半導体層の前記上面とほぼ等しい高さの上面を有する素子分離絶縁膜とを具備する。

【0030】

本発明の第2の視点による半導体装置の製造方法は、基板とこの基板上に設けられた第1の絶縁膜とこの第1の絶縁膜上に設けられた半導体層とからなり、第1乃至第4の領域を有するウエハを形成する工程と、前記第1の領域の前記半導体層上に第2の絶縁膜を形成する工程と、前記第2の絶縁膜をマスクとして、前記第2の領域の前記半導体層及び前記第1の絶縁膜を除去する工程と、前記第1の領域において、前記半導体層の前記第2の領域側の側面を前記第1の絶縁膜の側面よりも後退させて隙間部を形成する工程と、前記隙間部に第1の素子分離絶縁膜を形成する工程と、前記第2の領域において、エピタキシャル成長により前記半導体層の上面とほぼ等しくなるまでエピタキシャル層を前記基板上に形成する工程と、前記第2の絶縁膜を除去する工程と、前記第1の領域の前記半導体層上に第1のゲート絶縁膜を介して第1のゲート電極を形成するとともに、前記第2の領域の前記エピタキシャル層上に第2のゲート絶縁膜を介して第2のゲート電極を形成する工程とを具備する。

【0031】

【発明の実施の形態】

本発明の実施の形態は、SOI (Silicon On Insulator) 領域とバルク領域とを有するハイブリッドウエハを用いたものである。この本発明の実施の形態を以下に図面を参照して説明する。尚、この説明に際し、全図にわたり、共通する部分には共通する参照符号を付す。

【0032】

1. 第1の実施形態

第1の実施形態は、SOI 領域とバルク領域との境界において、SOI 層の側面を埋め込み絶縁膜の側面よりも横方向（基板に水平方向）に後退させて隙間を形成した後、この隙間にエピタキシャル成長時のマスク材を形成し、このマスク材をそのまま残して素子分離領域として利用するものである。

【0033】

以下に、第1の実施形態に係る第1乃至第4の例を説明する。

【0034】

[1-1] 第1の例

第1の実施形態に係る第1の例は、第1の実施形態の基本構造であり、SOI層とエピタキシャル層との間に隙間を形成し、この隙間に設けたエピタキシャル成長時のマスク材を素子分離領域として利用するものである。

【0035】

図1は、本発明の第1の実施形態に係る第1の例の半導体装置の断面図を示す。図1に示すように、第1の実施形態に係る第1の例において、SOI領域では、支持基板11上に埋め込み絶縁膜12が設けられ、この埋め込み絶縁膜12上にSOI層13が設けられている。一方、バルク領域では、支持基板11上にエピタキシャル層17が設けられ、このエピタキシャル層17の上面はSOI層13の上面とほぼ等しくなっている。

【0036】

ここで、SOI層13のエピタキシャル層17側の側面は埋め込み絶縁膜12のエピタキシャル層17側の側面よりも後退しているため、SOI層13とエピタキシャル層17間に隙間部15が存在し、この隙間部15を埋めるように埋め込み絶縁膜12上に素子分離領域16aが設けられている。この素子分離絶縁膜16aの上面は、SOI層13の上面及びエピタキシャル層17の上面とほぼ等しくなっている。

【0037】

このように、SOI領域のSOI層13とバルク領域のエピタキシャル層17とは、素子分離領域16aにより電氣的に分離されている。言い換えると、エピタキシャル層17は、埋め込み絶縁膜12と素子分離領域16aとは接しているが、SOI層13には接していない。

【0038】

尚、素子分離領域16aは、埋め込み絶縁膜12と同質の材料（例えばSiO₂膜）で形成することが望ましい。

【0039】

図2乃至図8は、本発明の第1の実施形態に係る第1の例の半導体装置の製造工程の断面図を示す。以下に、第1の実施形態に係る第1の例の製造方法について説明する。

【0040】

まず、図2に示すように、支持基板11と埋め込み絶縁膜12とSOI層13とを有するSOIウエハが用意される。ここで、支持基板11として比抵抗が 10Ω 程度のp型シリコン基板を用い、埋め込み絶縁膜12として膜厚が 150nm 程度の SiO_2 膜を用い、SOI層13として膜厚が 50nm 程度の単結晶シリコン膜を用いるが、これらに限定されない。

【0041】

次に、図3に示すように、SOI層13上に保護のための第1のマスク材14が堆積される。この第1のマスク材14は、例えば SiN 膜でもよいし、埋め込み絶縁膜12や後述する第2のマスク材16と同質の材料膜（例えば SiO_2 膜）でもよい。次に、フォトリソグラフィ及び異方性ドライエッチング（例えばRIE（Reactive Ion Etching））により、バルク領域における第1のマスク材14、SOI層13、埋め込み絶縁膜12が順次エッチング除去される。この際、異方性ドライエッチングのダメージを、バルク領域における支持基板11へ与えないようにするために、支持基板11上に薄い埋め込み絶縁膜12'を残すとよい。

【0042】

次に、図4に示すように、SOI層13の露出した側面が後退するように、SOI層13が等方性エッチング（例えばCDE（Chemical Dry Etching））で除去される。これにより、隙間部15が形成される。

【0043】

次に、図5に示すように、全面に、SOI層13の側壁保護用の第2のマスク材（例えば SiO_2 膜）16が堆積される。ここで、第2のマスク材16の膜厚Yを、SOI層13の膜厚Zの $1/2$ 以上に設定することにより、埋め込み絶縁膜12の側面よりもSOI層13の側面が後退した長さに相当する隙間部15の

幅Xに依存することなしに、第2のマスク材16で隙間部15を容易に埋め込むことが可能となる。

【0044】

次に、図6に示すように、等方性エッチングにより、第2のマスク材16及び埋め込み絶縁膜12'がエッチング除去される。この等方性エッチングとしては、HF溶液やNH₄F溶液等を用いたウエットエッチングを用いることができる。このようにして、隙間部15に第2のマスク材16からなる素子分離領域16aが形成され、バルク領域における支持基板11の上面が露出される。尚、隙間部15に素子分離領域16aとなるマスク材16が残るように、この工程におけるエッチング量を考慮して、後退させる長さX及び第2のマスク材16の膜厚Yを設定するとよい。

【0045】

次に、図7に示すように、露出した支持基板11上に、単結晶シリコンなどの素子形成用膜として、エピタキシャル成長技術によるエピタキシャル層17が形成される。このエピタキシャル成長では、エピタキシャル層17の上面がSOI層13の上面とほぼ一致するように、両者の高さ合わせを行う。

【0046】

尚、このエピタキシャル成長において、全面成長を行って、エピタキシャル層17をCMP (Chemical Mechanical Polish) でマスク材14の高さまで平坦化する方法でもよい。しかし、この場合、マスク材14の厚さ分だけSOI層13とエピタキシャル層17との高さの差が生じること、ディッシングやスクラッチによりエピタキシャル層17の平坦性や結晶性が劣化することがあり、またコストの面でもあまり好ましくない。

【0047】

次に、図8に示すように、エピタキシャル成長後、第1のマスク材14が除去される。

【0048】

次に、図1に示すように、ゲート絶縁膜20、21、ゲート電極22、23、STI (Shallow Trench Isolation) 構造の素子分離領域18、19がそれぞれ

形成される。

【0049】

上記第1の実施形態に係る第1の例によれば、次のような効果を得ることができる。

【0050】

(1) SOI層13の側面を埋め込み絶縁膜12の側面よりも後退させて、SOI層13とエピタキシャル層17間に隙間部15を設けることで、この隙間部15に形成されたSOI層13のマスク材16をそのまま素子分離領域16aとして使用することができる。このため、上記従来の第4の方法のようにマスク材116を除去する必要があるないので、マスク材116を除去した時に生じる窪み160も発生しない。従って、窪み160を無くするための大きなスペースの素子分離領域を形成する必要があるため、SOI領域とバルク領域との境界部における素子分離領域16aのスペースを縮小することができる。さらに、境界部の素子分離領域16aの深さについても、SOI層13の膜厚相当まで浅くすることができる。

【0051】

(2) 上記従来の第4の方法では、窪み160が発生した後、この窪み160内に電極131の材料が埋め込まれ、そして、この窪み160を無くすように素子分離領域130が形成されていた。このため、この窪み160内に電極材が深く埋め込まれると、素子分離領域130の加工後にも窪み160内に電極材が残渣として残る場合があり、SOI領域とバルク領域における同一境界をゲート電極が複数横切り、互いにショート不良が生じる恐れがあった。

【0052】

これに対し、第1の実施形態に係る第1の例によれば、上述するように、従来のような窪み160は生じないため、上記のようなショート不良の問題を回避することができる。

【0053】

(3) 上記従来の第4の方法では、埋め込み絶縁膜112''を除去する工程（図44の工程）において、SOI層113の側面がエッチングされないように、

この側面に埋め込み絶縁膜 112 と異質の材料からなる第 2 のマスク材 116 を設けていた。従って、埋め込み絶縁膜 112 のみが除去されるようなエッチング条件を設定すると、第 2 のマスク材 116 はエッチングされないため、埋め込み絶縁膜 112 のみが大幅にエッチングされ、第 2 のマスク材 116 の側面よりも埋め込み絶縁膜 112 の側面が後退したオーバーハングが生じることがあった。そして、このオーバーハングの生じた状態でエピタキシャル層 117 を形成すると、オーバーハングした部分に空洞や結晶欠陥が生じてしまう。

【0054】

これに対し、第 1 の実施形態に係る第 1 の例によれば、素子分離領域 16a は、埋め込み絶縁膜 12 と同質の材料（例えば SiO₂ 膜）で形成することができる。従って、埋め込み絶縁膜 12' を除去する工程（図 6 の工程）において、SOI 層 13 の側面がエッチングされることを防止しながらも、埋め込み絶縁膜 12' とマスク材 16 を同時に除去できるため、従来のようなオーバーハングの問題も生じない。これにより、エピタキシャル層 17 に、オーバーハングによる空洞や結晶欠陥が生じる恐れもない。

【0055】

[1-2] 第 2 の例

第 1 の実施形態による第 2 の例は、SOI 領域とバルク領域との間の領域において、SOI 層とエピタキシャル層とを電氣的に絶縁させる部分と導通させる部分とをそれぞれ設けたものである。

【0056】

図 9 は、本発明の第 1 の実施形態に係る第 2 の例において、SOI 層とエピタキシャル層とを電氣的に絶縁させる部分と導通させる部分の半導体装置の断面図を示す。

【0057】

図 9 において、紙面の左側の領域（以下、絶縁領域と称す）は、SOI 層 13-A とエピタキシャル層 17-A とが電氣的に絶縁された部分を示している。この絶縁領域については、上記第 1 の実施形態に係る第 1 の例と同様の構造であるため説明は省略する。

【0058】

一方、図9において、紙面の右側の領域（以下、導通領域と称す）は、SOI層13-Bとエピタキシャル層17-Bとが電氣的に導通された部分を示している。つまり、SOI層13-Bとエピタキシャル層17-Bとが直接接している。その他の構造は、絶縁領域と同様の構造である。

【0059】

図10乃至図15は、本発明の第1の実施形態に係る第2の例の半導体装置の製造工程の断面図を示す。以下に、第1の実施形態に係る第2の例の製造方法について説明する。ここでは、上記第1の例と同じ構造となる絶縁領域については説明を簡略化する。

【0060】

まず、図10に示すように、導通領域では、上記第1の例と同様に、薄い埋め込み絶縁膜12'-Bが残された後、レジスト25が形成され、SOI層13-Bの側面が覆われる。次に、絶縁領域では、隙間部15が形成される。この際、導通領域では、SOI層13-Bの側面がレジスト25で覆われているため隙間部15は形成されない。

【0061】

次に、図11に示すように、導通領域におけるレジスト25が除去される。

【0062】

次に、図12に示すように、全面に第2のマスク材（例えばSiO₂膜）16が堆積される。尚、絶縁領域では、隙間部15内に第2のマスク材16が形成される。

【0063】

次に、図13に示すように、HF溶液やNH₄F溶液等を用いたウエットエッチングにより、第2のマスク材16及び埋め込み絶縁膜12'-A、12'-Bがエッチング除去される。これにより、バルク領域における支持基板11-A、11-Bの上面が露出される。尚、絶縁領域では、隙間部15に第2のマスク材16からなる素子分離領域16aが形成される。

【0064】

次に、図 14 に示すように、露出した支持基板 11-A, 11-B 上に、単結晶シリコンなどの素子形成用膜として、エピタキシャル成長技術によるエピタキシャル層 17-A, 17-B が形成される。このエピタキシャル成長では、エピタキシャル層 17-A, 17-B の上面が SOI 層 13-A, 13-B の上面とほぼ一致するように、両者の高さ合わせを行う。尚、導通領域では、SOI 層 13-B とエピタキシャル層 17-B は直接接するが、絶縁領域では、素子分離領域 16a が存在するため、SOI 層 13-A とエピタキシャル層 17-A は直接接しない。

【0065】

次に、図 15 に示すように、第 1 のマスク材 14-A, 14-B が除去される。

【0066】

次に、図 9 に示すように、ゲート絶縁膜 20-A, 20-B, 21-A, 21-B、ゲート電極 22-A, 22-B, 23-A, 23-B、STI 構造の素子分離領域 18-A, 18-B, 19-A, 19-B がそれぞれ形成される。

【0067】

上記第 1 の実施形態に係る第 2 の例によれば、絶縁領域では、第 1 の実施形態に係る第 1 の例と同様の効果を得ることができる。また、導通領域では、SOI 層 13-B とエピタキシャル 17-B とが直接接するため、両者を電氣的に接続したい場合に有効である。

【0068】

[1-3] 第 3 の例

第 1 の実施形態による第 3 の例は、エピタキシャル成長によってファセットが生じた場合、第 1 の例におけるマスク材をそのまま素子分離領域として使用せずに、ファセットを除去するように素子分離領域を改めて形成するものである。

【0069】

図 16 は、本発明の第 1 の実施形態に係る第 3 の例の半導体装置の断面図を示す。図 16 に示すように、第 1 の実施形態に係る第 3 の例において、上記第 1 の例と異なる部分は、エピタキシャル層 17 のファセットを除去するために、マス

ク材ではない素子分離領域 30 を改めて形成しているところである。この素子分離領域 30 は、SOI 層 13 内からエピタキシャル層 17 内にまで形成されている。また、この素子分離領域 30 は、埋め込み絶縁膜 12 を貫いて基板 11 内に至るまで形成してもよいが、SOI 層 13 とエピタキシャル層 17 とが電氣的に絶縁されればよいので、必ずしも基板 11 内に至るまで形成する必要はない。

【0070】

図 17 及び図 18 は、本発明の第 1 の実施形態に係る第 3 の例の半導体装置の製造工程の断面図を示す。以下に、第 1 の実施形態に係る第 3 の例の製造方法について説明する。ここでは、上記第 1 の例と異なる構造となる領域についてのみ説明する。

【0071】

まず、図 17 に示すように、露出した支持基板 11 上に、単結晶シリコンなどの素子形成用膜として、エピタキシャル成長技術によるエピタキシャル層 17 が形成される。このエピタキシャル成長では、エピタキシャル層 17 の上面が SOI 層 13 の上面とほぼ一致するように両者の高さ合わせを行うが、エピタキシャル層 17 の SOI 領域側の上端部にファセット 26 が生じる場合がある。

【0072】

次に、図 18 に示すように、第 1 のマスク材 14 が除去される。

【0073】

次に、図 16 に示すように、ゲート絶縁膜 20、21 が形成された後、ファセットが無くなるように STI 構造の素子分離領域 30 が形成され、これと同時に SOI 領域及びバルク領域内の素子分離領域 18、19 も形成される。その後、ゲート電極 22、23、31 がそれぞれ形成される。

【0074】

上記第 1 の実施形態に係る第 3 の例によれば、SOI 領域とバルク領域の境界にファセットが無くなるように素子分離領域 30 を形成するため、上記第 1 の例においてエピタキシャル成長後にファセットが生じた場合に有効である。

【0075】

尚、第 3 の例の素子分離領域 30 は、第 1 の例の素子分離領域 16a よりもス

ペースが大きくなるが、従来のような深い窪み 160 を無くするために形成するわけではないため、従来よりも十分に素子分離領域のスペースの縮小を図れることは言うまでもない。

【0076】

[1-4] 第4の例

SOI 領域とバルク領域の境界における素子分離領域は、第1の実施形態による第1の例では、SOI 層とエピタキシャル層との間にのみ形成されていたが、第1の実施形態による第4の例では、SOI 層とエピタキシャル層との間に加えて、埋め込み絶縁膜とエピタキシャル層との間にも形成されている。

【0077】

図19は、本発明の第1の実施形態に係る第4の例の半導体装置の断面図を示す。図19に示すように、第1の実施形態に係る第4の例では、上記第1の例と素子分離領域 16a の形成されている位置が異なる。つまり、素子分離領域 16a は、SOI 層 13 とエピタキシャル層 17 との間に加えて、埋め込み絶縁膜 12 とエピタキシャル層 17 との間にも形成されている。

【0078】

ここで、埋め込み絶縁膜 12 のエピタキシャル層 17 側の側面は SOI 層 13 のエピタキシャル層 17 側の側面よりも後退しており、SOI 層 13 とエピタキシャル層 17 間の隙間部 15 の幅よりも埋め込み絶縁膜 12 とエピタキシャル層 17 間の隙間部 35 の幅の方が大きい。言い換えると、SOI 層 13 のエピタキシャル層 17 側の側面は、埋め込み絶縁膜 12 のエピタキシャル層 17 側の側面よりも突出した構造になっている。

【0079】

尚、この第4の例のように、素子分離領域 16a とエピタキシャル層 17 との接触面が大きい場合は、エピタキシャル成長時のファセットを抑制するために、素子分離領域 16a を SiN 膜で形成するのが好ましい。

【0080】

図20乃至図25は、本発明の第1の実施形態に係る第4の例の半導体装置の製造工程の断面図を示す。以下に、第1の実施形態に係る第4の例の製造方法に

ついて説明する。ここでは、上記第 1 の例と異なる構造となる領域についてののみ説明する。

【0081】

まず、図 20 に示すように、支持基板 11 と埋め込み絶縁膜 12 と SOI 層 13 とを有する SOI ウエハ上に、保護のための第 1 のマスク材 14 が堆積される。この第 1 のマスク材 14 は、例えば SiN 膜や SiO₂ 膜等で形成すればよいが、埋め込み絶縁膜 12 と異なる材質の膜で形成するのが好ましい。次に、異方性エッチング（例えば RIE）により、バルク領域における第 1 のマスク材 14、SOI 層 13、埋め込み絶縁膜 12 が順次エッチング除去される。この際、異方性ドライエッチングのダメージを、バルク領域における支持基板 11 へ与えないようにするために、支持基板 11 上に薄い埋め込み絶縁膜 12' を残すとよい。そして、SOI 層 13 の側面を埋め込み絶縁膜 12 の側面よりも後退させ、隙間部 15 が形成される。

【0082】

次に、図 21 に示すように、等方性エッチングにより、埋め込み絶縁膜 12 の側面が第 1 のマスク材 14 の側面よりも後退するように、埋め込み絶縁膜 12 がエッチングされ、隙間部 35 が形成される。

【0083】

次に、図 22 に示すように、全面に、SOI 層 13 の側壁保護用の第 2 のマスク材（例えば SiN 膜）16 が堆積される。

【0084】

次に、図 23 に示すように、等方性エッチングにより、第 2 のマスク材 16 及び埋め込み絶縁膜 12' がエッチング除去される。このようにして、隙間部 15、35 に第 2 のマスク材 16 からなる素子分離領域 16a が形成され、バルク領域における支持基板 11 の上面が露出される。

【0085】

次に、図 24 に示すように、露出した支持基板 11 上に、単結晶シリコンなどの素子形成用膜として、エピタキシャル成長技術によるエピタキシャル層 17 が形成される。このエピタキシャル成長では、エピタキシャル層 17 の上面が SO

I 層 13 の上面とはほぼ一致するように、両者の高さ合わせを行う。

【0086】

次に、図 25 に示すように、エピタキシャル成長後、第 1 のマスク材 14 が除去される。

【0087】

次に、図 19 に示すように、ゲート絶縁膜 20、21、ゲート電極 22、23、31、STI 構造の素子分離領域 18、19 がそれぞれ形成される。

【0088】

上記第 1 の実施形態に係る第 4 の例によれば、上記第 1 の例と同様に、エピタキシャル成長時の SOI 層 13 のマスク材 16 をそのまま素子分離領域 16a として使用することができるため、素子分離領域のスペースの縮小を図ることができる。

【0089】

尚、第 4 の例の素子分離領域 16a は、第 1 の例の素子分離領域 16a よりもスペースが大きくなるが、従来のような深い窪み 160 を無くすために形成するわけではないため、従来よりも十分に素子分離領域のスペース（特に素子分離領域の横幅）の縮小を図れることは言うまでもない。

【0090】

また、素子分離領域 16a を、埋め込み絶縁膜 12 と異質材である SiN 膜で形成している。ここで、選択エピタキシャル成長において、エピタキシャル層 17 は、SiO₂ 膜と境界面を形成する場合よりも SiN 膜と境界面を形成する場合の方が、ファセットを小さくできる（あるいはファセットを無くすことができる）ことが知られている。従って、SiN 膜からなる素子分離領域 16a を設けることで、素子分離領域 16a とエピタキシャル層 17 との境界におけるファセットを抑制できる。

【0091】

尚、ここでは、埋め込み絶縁膜 12 の側面が SOI 層 13 の側面より後退する場合を示したが、両者の側面を第 1 のマスク材 14 の側面よりも後退させて隙間部 15、35 を形成することが重要であるだけで、図 19 の構造に限定されるわ

けではない。例えば図 26 に示すように、SOI 層 13 の側面が埋め込み絶縁膜 12 の側面より後退していても構わない。従って、隙間部 15 の幅が隙間部 35 の幅より小さくてもよいし（図 19）、隙間部 35 の幅が隙間部 15 の幅より小さくてもよい（図 26）。

【0092】

2. 第 2 の実施形態

第 2 の実施形態は、エピタキシャル成長を行わないことで、SOI 領域とバルク領域の境界における素子分離領域のスペースの縮小を図る例である。

【0093】

以下に、第 2 の実施形態に係る第 1 及び第 2 の例を説明する。

【0094】

[2-1] 第 1 の例

第 2 の実施形態に係る第 1 の例は、SOI 領域とバルク領域に 2 層構造のゲート電極をそれぞれ形成し、この両者のゲート電極の下面の高さは異なるが、両者のゲート電極の上面の高さをほぼ同じにするものである。

【0095】

図 27 は、本発明の第 2 の実施形態に係る第 1 の例の半導体装置の断面図を示す。図 27 に示すように、SOI 領域では、SOI 層 13 上にゲート絶縁膜 20 が設けられ、このゲート絶縁膜 20 上にゲート電極 45 が設けられている。このゲート電極 45 は、下部電極層 43a と上部電極層 44a とからなる 2 層構造になっている。

【0096】

バルク領域では、支持基板 11 上にゲート絶縁膜 21 が設けられ、このゲート絶縁膜 21 上にゲート電極 46 が設けられている。このゲート電極 46 は、下部電極層 43b と上部電極層 44b とからなる 2 層構造になっている。

【0097】

SOI 領域におけるゲート電極 45 とバルク領域におけるゲート電極 46 とは、ゲート電極下の基板の高さは異なるが、ゲート電極の上面の高さはほぼ等しくなっている。つまり、バルク領域のゲート電極 46 の電極層 43b が、SOI 領

域とバルク領域のゲート電極下の基板の高さの差を埋めるように、SOI領域のゲート電極45の電極層43aよりも厚くなっている。

【0098】

また、SOI領域とバルク領域との境界部分には、STI構造の素子分離領域41が形成されている。これにより、SOI層13とバルク領域の基板11とが電氣的に分離されている。さらに、SOI領域及びバルク領域内には、それぞれ素子分離領域40、42が形成されている。ここで、素子分離領域41は、埋め込み絶縁膜12と異質材で形成することが望ましい。

【0099】

図28乃至図32は、本発明の第2の実施形態に係る第1の例の半導体装置の製造工程の断面図を示す。以下に、第2の実施形態に係る第1の例の製造方法について説明する。

【0100】

まず、図28に示すように、支持基板11と埋め込み絶縁膜12とSOI層13とを有するSOIウエハが用意される。次に、SOI層13の表面から支持基板11にまで貫通する素子分離領域40、41、42がそれぞれ形成される。ここで、素子分離領域40、41、42の上部がSOI層13の上面よりも突出するようにし、凹部48が形成されるようにする。

【0101】

次に、図29に示すように、バルク領域においては、SOI層13及び埋め込み絶縁膜12がそれぞれ除去される。これにより、SOI領域では、凹部48が形成された状態のままであり、バルク領域では、凹部48よりも深い凹部49が形成される。

【0102】

ここで、埋め込み絶縁膜12を除去する際は、下地の支持基板11へダメージを与えないように、少なくとも最終ステップにはウエットエッチングを用いるのが好ましい。

【0103】

また、この際、バルク領域の素子分離領域41、42にも同様にダメージを与

えないようにするために、素子分離領域用の溝内には、SiNライナー（薄膜SiN膜）を敷いたり、埋め込み絶縁膜12と異なる材料を埋め込んだりすることが望ましい。

【0104】

次に、図30に示すように、SOI層13上にゲート絶縁膜20が形成され、支持基板11上にゲート絶縁膜21が形成される。次に、ゲート絶縁膜20、21及び素子分離領域40、41、42上に第1の電極材43が形成される。

【0105】

次に、図31に示すように、CMPにより、素子分離領域40、41、42の上面が露出するまで、第1の電極材43の上面が平坦化される。これにより、SOI領域におけるゲート電極の下部電極層43aが凹部48内に形成されるとともに、バルク領域におけるゲート電極の下部電極層43bが凹部49内に形成される。その結果、SOI領域における下部電極層43aの上面とバルク領域における下部電極層43bの上面とを等しい高さにでき、SOI領域とバルク領域間の段差が解消される。

【0106】

次に、図32に示すように、下部電極層43a、43b及び素子分離領域40、41、42上に第2の電極材44が形成される。

【0107】

次に、図27に示すように、下部電極層43a、43b及び第2の電極材44が一括加工される。これにより、SOI領域においては、下部電極層43aと上部電極層44aとからなるゲート電極45が形成され、バルク領域においては、下部電極層43bと上部電極層44bとからなるゲート電極46が形成される。

【0108】

上記第2の実施形態に係る第1の例によれば、次のような効果を得ることができる。

【0109】

(1) 第2の実施形態に係る第1の例では、バルク領域で選択エピタキシャル成長を行わないため、エピタキシャル成長時のマスク材をSOI層13の側面に

設ける必要がない。従って、マスク材を除去することによる窪み 160 も生じないため、窪み 160 を無くすための大きな素子分離領域を形成する必要がない。従って、SOI 領域とバルク領域との境界部における素子分離領域 41 のスペースを縮小することができる。

【0110】

(2) 従来技術では、エピタキシャル成長時に、選択成長の膜厚のばらつきにより SOI 層 13 とエピタキシャル層 17 と間の段差が生じる恐れがあり、この段差が残った状態でゲート電極を形成すると、SOI 領域とバルク領域で同じ高さのゲート電極を形成することができない。

【0111】

これに対し、第 2 の実施形態に係る第 1 の例では、バルク領域で選択エピタキシャル成長を行わないため、SOI 領域とバルク領域間に段差が生じるが、ゲート電極の下部電極層 43a, 43b でこの段差を解消することができる。このため、SOI 領域とバルク領域で同じ高さのゲート電極 45, 46 を形成することができる。

【0112】

[2-2] 第 2 の例

第 2 の実施形態に係る第 2 の例は、上記第 2 の例を変形したものであり、バルク領域に EEPROM を形成した例である。

【0113】

図 33 は、本発明の第 2 の実施形態に係る第 2 の例の半導体装置の断面図を示す。ここでは、上記第 1 の例と異なる構造を中心に説明する。

【0114】

図 33 に示すように、第 2 の実施形態に係る第 2 の例では、バルク領域において、上部電極層 44b と下部電極層 43b との間に例えば ONO (Oxide Nitride Oxide) 膜などの絶縁膜 47 を設けている。つまり、バルク領域では、下部電極層 43b をフローティングゲートとし、上部電極層 44b をコントロールゲートとした EEPROM セルを形成している。

【0115】

また、第2の例では、SOI領域とバルク領域間の段差を解消する構造が第1の例とは異なる。すなわち、下部電極層43bは下部電極層43aとほぼ等しい厚さで形成し、上部電極層44b及び絶縁膜47でSOI領域とバルク領域間の段差を解消している。

【0116】

また、バルク領域において、下部電極層43bは、凹部49の側面（素子分離領域41，42の側面）に沿って形成された側面部分と、凹部49の底面（ゲート絶縁膜21上）に沿って形成された底面部分とを有している。そして、絶縁膜47は、下部電極層43bの側面部分に沿って形成された側面部分と、下部電極層43bの底面部分に沿って形成された底面部分と、素子分離領域41，42及び下部電極層43bの上面に沿って形成された上面部分とを有する。すなわち、バルク領域における下部電極層43b及び絶縁膜47は、凹部49の形状に沿った凹型構造になっている。さらに、上部電極層44bは下部電極層43b及び絶縁膜47からなる凹型構造の窪みを埋めるように形成されるため、上部電極層44bの中央部が端部よりも厚くなっている。

【0117】

上記第2の実施形態に係る第2の例によれば、第2の実施形態に係る第1の例と同様の効果を得ることができる。

【0118】

さらに、第2の例では、SOI領域とバルク領域間の段差を利用して、バルク領域における下部電極層43b及び絶縁膜47を凹形状にしている。これにより、上部電極層44b及び下部電極層43b間のカップリング比を確保することが可能となり、セルの安定動作に寄与するというメリットもある。

【0119】

3. 第3の実施形態

第3の実施形態は、SOI領域における埋め込み絶縁膜及びSOI層を、バルク領域ではゲート絶縁膜及びゲート電極として使用する例である。

【0120】

以下に、第3の実施形態に係る第1及び第2の例を説明する。

【0121】

[3-1] 第1の例

第3の実施形態に係る第1の例は、SOI領域における埋め込み絶縁膜及びSOI層を、バルク領域ではゲート絶縁膜及びゲート電極として使用した基本構造である。

【0122】

図34は、本発明の第3の実施形態に係る第1の例の半導体装置の断面図を示す。図34に示すように、第3の実施形態に係る第1の例の半導体装置は、SOI領域における埋め込み絶縁膜12aを比較的薄く形成することで、この埋め込み絶縁膜12aとして使用している絶縁膜を、バルク領域におけるゲート絶縁膜12bとして使用している。また、SOI領域におけるSOI層13aとして使用している層を、バルク領域におけるゲート電極54の下部電極層13bとして使用している。また、SOI領域におけるゲート電極として使用している電極層を、バルク領域におけるゲート電極54の上部電極53bとして使用している。

【0123】

そして、SOI領域におけるゲート電極53aとバルク領域におけるゲート電極54とは、ゲート電極53a、54下の基板の高さは異なるが、ゲート電極53a、54の上面の高さはほぼ等しくなっている。つまり、バルク領域のゲート電極54を2層構造にすることで、SOI領域とバルク領域のゲート電極下における基板の高さの差を埋めている。

【0124】

ここで、SOI層13aが例えば単結晶シリコン層で形成された場合、バルク領域のゲート電極54の一部の層（下部電極層13b）は、単結晶シリコン層で形成されることになる。

【0125】

図35乃至図36は、本発明の第3の実施形態に係る第1の例の半導体装置の製造工程の断面図を示す。以下に、第3の実施形態に係る第1の例の製造方法について説明する。

【0126】

まず、図 35 に示すように、支持基板 11 と埋め込み絶縁膜 12 と SOI 層 13 とを有する SOI ウエハが用意される。次に、SOI 層 13 の表面から支持基板 11 にまで貫通する素子分離領域 50, 51, 52 がそれぞれ形成される。これにより、SOI 領域においては、埋め込み絶縁膜 12a 及び SOI 層 13a が形成される。また、バルク領域においては、埋め込み絶縁膜 12 からなるゲート絶縁膜 12b が形成されるとともに、SOI 層 13 からなるゲート電極用の下部電極層 13b が形成される。

【0127】

次に、図 36 に示すように、SOI 領域において、SOI 層 13a 上にゲート絶縁膜 20 が形成される。その後、全面に電極材 53 が形成される。

【0128】

次に、図 34 に示すように、電極材 53 及び下部電極層 13b が一括加工される。これにより、SOI 領域においては、電極材 53 からなるゲート電極 53a が形成され、バルク領域においては、下部電極層 13b と電極材 53 からなる上部電極層 53b とからなる 2 層構造のゲート電極 54 が形成される。

【0129】

上記第 3 の実施形態に係る第 1 の例によれば、次のような効果を得ることができる。

【0130】

(1) 第 3 の実施形態に係る第 1 の例では、バルク領域で選択エピタキシャル成長を行わないため、エピタキシャル成長時のマスク材を SOI 層 13 の側面に設ける必要がない。従って、マスク材を除去することによる窪み 160 も生じないため、窪み 160 を無くすための大きな素子分離領域を形成する必要がない。従って、SOI 領域とバルク領域との境界部における素子分離領域 51 のスペースを縮小することができる。

【0131】

(2) 従来技術では、エピタキシャル成長時に、選択成長の膜厚のばらつきにより SOI 層 13 とエピタキシャル層 17 と間の段差が生じる恐れがあり、この段差が残った状態でゲート電極を形成すると、SOI 領域とバルク領域で同じ高

さのゲート電極を形成することができない。

【0132】

これに対し、第3の実施形態に係る第1の例では、バルク領域で選択エピタキシャル成長を行わないため、SOI領域とバルク領域間に段差が生じるが、バルク領域のゲート電極54を2層構造にすることで、この段差を解消することができる。このため、SOI領域とバルク領域で同じ高さのゲート電極53a、54を形成することができる。

【0133】

(3) 第3の実施形態に係る第1の例では、SOI領域において、埋め込み絶縁膜12a、SOI層13a及びゲート電極53aとして使用した材料層を、バルク領域では、ゲート絶縁膜12b、ゲート電極54の下部電極層13b及び上部電極層53bの材料層としてそれぞれ使用している。従って、バルク領域における素子を形成するにあたり、新たな工程を設ける必要がないため、プロセスが容易となる。

【0134】

(4) 第3の実施形態に係る第1の例では、SOI領域の埋め込み絶縁膜12aをバルク領域のゲート絶縁膜12bとして使用し、SOI領域のSOI層13aをバルク領域のゲート電極(下部電極層13b)として使用している。ここで、本実施形態におけるSOI層13が単結晶シリコンで形成された場合、従来の多結晶シリコンで形成された場合のグレインが無い場合、本実施形態ではグレインに関わる不具合を回避することができる。例えば、一様な膜厚のゲート絶縁膜を形成することが可能となり、微視的な耐圧の劣化がなく、より薄膜化が可能となる。また、単結晶シリコンからなるゲート電極は、多結晶シリコンからなるゲート電極よりも、配線の低抵抗化を図ることができる。

【0135】

[3-2] 第2の例

第3の実施形態に係る第2の例は、上記第1の例において、バルク領域にEEPROMを追加したものである。

【0136】

図 37 は、本発明の第 3 の実施形態に係る第 2 の例の半導体装置の断面図を示す。図 37 に示すように、第 3 の実施形態に係る第 2 の例の半導体装置は、SOI 領域には 1 層構造のゲート電極 53a を形成し、バルク領域には 2 層構造のゲート電極 54 と EEPROM のゲート電極 56 とを形成している。

【0137】

ここで、バルク領域の EEPROM において、ゲート絶縁膜 12c は埋め込み絶縁膜 12a 及びゲート絶縁膜 12b と同じ膜 12 で形成され、フローティングゲートとして機能する下部電極層 13c は SOI 層 13a 及び下部電極層 13b と同じ層 13 で形成され、絶縁膜 20b はゲート絶縁膜 20a と同じ膜 20 で形成され、コントロールゲートとして機能する上部電極層 53c はゲート電極 53a 及び上部電極層 53b と同じ層 53 で形成されている。

【0138】

そして、SOI 領域におけるゲート電極 53a とバルク領域におけるゲート電極 54、56 とは、ゲート電極 53a とゲート電極 54、56 下の基板の高さは異なるが、ゲート電極 53a、54、56 の上面の高さはほぼ等しくなっている。つまり、バルク領域のゲート電極 54、56 を 2 層構造にすることで、SOI 領域とバルク領域のゲート電極下における基板の高さの差を埋めている。

【0139】

上記第 3 の実施形態に係る第 2 の例によれば、第 3 の実施形態に係る第 1 の例と同様の効果を得ることができる。

【0140】

さらに、バルク領域に EEPROM を形成する場合、ゲート絶縁膜 12c、下部電極層 13c、絶縁膜 20b 及び上部電極層 53c は、埋め込み絶縁膜 12a、SOI 層 13a、ゲート絶縁膜 20a、ゲート電極 53a と同じ層を利用して、それぞれ形成する。このため、バルク領域の EEPROM を形成する新たな工程を設ける必要がないためプロセスが容易となる。

【0141】

その他、本発明は、上記各実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で、例えば以下のように、種々に変形することが可能

である。

【0142】

(1) バルク領域における埋め込み絶縁膜 12 の最終的な除去方法は、ウエットエッチングに限定されない。例えば、RIEで埋め込み絶縁膜 12 を除去した後、支持基板 11 に生じたダメージ層をさらに除去するような方法にしてもよい。

【0143】

(2) SOI 層 13 が後退して形成された隙間部 15 は、第 2 のマスク材 16 で埋め込んでいるが、この第 2 のマスク材 16 で埋め込む工程を省略することも可能である。

【0144】

この場合、エピタキシャル層 17 の形成時に、SOI 層 13 の後退した側面からもエピタキシャル成長がなされる可能性があるが、SOI 層 13 の側面の後退量（隙間部 15 の幅）を大きくすることで、SOI 層 13 とエピタキシャル層 17 とが接続されないように制御することも可能である。

【0145】

さらに、レジストプロセスを用いて前記後退量の異なる領域を形成し、この後退量の大小のみで、第 1 の実施形態における第 2 の例で説明したような絶縁領域と導通領域とを作り分けることも可能である。

【0146】

また、隙間部 15 を埋め込まないことで、絶縁領域の境界付近の埋め込み絶縁膜 12 上に、SOI 層 13 の膜厚分の段差が存在することになるが、この点は SOI 層 13 が十分に薄膜であれば問題とならない。

【0147】

(3) 隙間部 15 は、次のように形成することも可能である。まず、図 38 に示すように、第 1 のマスク材 14 が RIE でパターニングされる。次に、SOI 層 13 が等方性エッチングを用いて除去され、隙間部 15 が形成される。この際、等方性エッチングとしては、例えば、CDE によるドライエッチングや、KOH 溶液によるウエットエッチング等が用いられる。従って、この場合、SOI 層

13の側面に順テーパ面62が形成されるため、素子形成に膜残り等の支障を来す心配がさらになくなる。そして、隙間部15が形成された後に、バルク領域の埋め込み絶縁膜12が、RIE及びウエットエッチングでエッチングされる。その後、上述したような隙間部15を埋め込まないプロセスを経た場合、図39又は図40のような構造が完成する。

【0148】

ここで、図39は、エピタキシャル層17にファセットが生じなかった場合の構造を示し、図40は、エピタキシャル層17にファセット26が生じた場合の構造を示す。

【0149】

尚、上記のようにSOI層13の側面に順テーパ面62を形成した場合、隙間部15を第2のマスク材16で埋め込んでも構わない。

【0150】

(4) 素子分離領域16aの形成は、バルク領域のSOI層13及び埋め込み絶縁膜12を除去した後に行ったが、これに限定されない。例えば、素子分離領域16aを少なくともSOI領域とバルク領域との境界部に形成した後に、バルク領域のSOI層13及び埋め込み絶縁膜12を除去し、その後、エピタキシャル成長を行うようにしても構わない。

【0151】

(5) SOI層13、埋め込み絶縁膜12、支持基板11、マスク材14、16、エピタキシャル層17における材質や結晶性に関して、デバイス形成に適用される種々のものを適用することが可能である。

【0152】

(6) 素子分離領域16aの上面は、SOI層13及びエピタキシャル層17の上面とほぼ等しい高さであることに限定されず、SOI層13及びエピタキシャル層17の上面よりも多少高くなったり多少低くなったりする場合もあり得る。例えば、素子分離領域16aが酸化膜の場合、酸化膜の除去処理によって、素子分離領域16aの上面がSOI層13及びエピタキシャル層17の上面よりも低くなる場合はあり得る。また、素子分離領域16aが窒化膜の場合、酸化や酸

化膜の除去処理によって素子分離領域 16 a の上面の高さは変わらないが、酸化や酸化膜の除去処理によって S O I 層 13 及びエピタキシャル層 17 の上面が低くなるため、結果として、素子分離領域 16 a の上面が S O I 層 13 及びエピタキシャル層 17 の上面よりも高くなる場合もあり得る。

【0153】

さらに、上記実施形態には種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適宜な組み合わせにより種々の発明が抽出され得る。例えば、実施形態に示される全構成要件から幾つかの構成要件が削除されても、発明が解決しようとする課題の欄で述べた課題が解決でき、発明の効果の欄で述べられている効果が得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明として抽出され得る。

【0154】

【発明の効果】

以上説明したように本発明によれば、S O I 領域とバルク領域との境界部における素子分離領域のスペースを縮小することが可能な半導体装置及びその製造方法を提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明の第 1 の実施形態に係わる第 1 の例の半導体装置を示す断面図。

【図 2】 本発明の第 1 の実施形態に係わる第 1 の例の半導体装置の製造工程を示す断面図。

【図 3】 図 2 に続く、本発明の第 1 の実施形態に係わる第 1 の例の半導体装置の製造工程を示す断面図。

【図 4】 図 3 に続く、本発明の第 1 の実施形態に係わる第 1 の例の半導体装置の製造工程を示す断面図。

【図 5】 図 4 に続く、本発明の第 1 の実施形態に係わる第 1 の例の半導体装置の製造工程を示す断面図。

【図 6】 図 5 に続く、本発明の第 1 の実施形態に係わる第 1 の例の半導体装置の製造工程を示す断面図。

【図 7】 図 6 に続く、本発明の第 1 の実施形態に係わる第 1 の例の半導体装置の製造工程を示す断面図。

【図 8】 図 7 に続く、本発明の第 1 の実施形態に係わる第 1 の例の半導体装置の製造工程を示す断面図。

【図 9】 本発明の第 1 の実施形態に係わる第 2 の例の半導体装置を示す断面図。

【図 1 0】 本発明の第 1 の実施形態に係わる第 2 の例の半導体装置の製造工程を示す断面図。

【図 1 1】 図 1 0 に続く、本発明の第 1 の実施形態に係わる第 2 の例の半導体装置の製造工程を示す断面図。

【図 1 2】 図 1 1 に続く、本発明の第 1 の実施形態に係わる第 2 の例の半導体装置の製造工程を示す断面図。

【図 1 3】 図 1 2 に続く、本発明の第 1 の実施形態に係わる第 2 の例の半導体装置の製造工程を示す断面図。

【図 1 4】 図 1 3 に続く、本発明の第 1 の実施形態に係わる第 2 の例の半導体装置の製造工程を示す断面図。

【図 1 5】 図 1 4 に続く、本発明の第 1 の実施形態に係わる第 2 の例の半導体装置の製造工程を示す断面図。

【図 1 6】 本発明の第 1 の実施形態に係わる第 3 の例の半導体装置を示す断面図。

【図 1 7】 本発明の第 1 の実施形態に係わる第 3 の例の半導体装置の製造工程を示す断面図。

【図 1 8】 図 1 7 に続く、本発明の第 1 の実施形態に係わる第 3 の例の半導体装置の製造工程を示す断面図。

【図 1 9】 本発明の第 1 の実施形態に係わる第 4 の例の半導体装置を示す断面図。

【図 2 0】 本発明の第 1 の実施形態に係わる第 4 の例の半導体装置の製造工程を示す断面図。

【図 2 1】 図 2 0 に続く、本発明の第 1 の実施形態に係わる第 4 の例の半

導体装置の製造工程を示す断面図。

【図 2 2】 図 2 1 に続く、本発明の第 1 の実施形態に係わる第 4 の例の半導体装置の製造工程を示す断面図。

【図 2 3】 図 2 2 に続く、本発明の第 1 の実施形態に係わる第 4 の例の半導体装置の製造工程を示す断面図。

【図 2 4】 図 2 3 に続く、本発明の第 1 の実施形態に係わる第 4 の例の半導体装置の製造工程を示す断面図。

【図 2 5】 図 2 4 に続く、本発明の第 1 の実施形態に係わる第 4 の例の半導体装置の製造工程を示す断面図。

【図 2 6】 本発明の第 1 の実施形態に係わる第 4 の例の他の半導体装置を示す断面図。

【図 2 7】 本発明の第 2 の実施形態に係わる第 1 の例の半導体装置を示す断面図。

【図 2 8】 本発明の第 2 の実施形態に係わる第 1 の例の半導体装置の製造工程を示す断面図。

【図 2 9】 図 2 8 に続く、本発明の第 2 の実施形態に係わる第 1 の例の半導体装置の製造工程を示す断面図。

【図 3 0】 図 2 9 に続く、本発明の第 2 の実施形態に係わる第 1 の例の半導体装置の製造工程を示す断面図。

【図 3 1】 図 3 0 に続く、本発明の第 2 の実施形態に係わる第 1 の例の半導体装置の製造工程を示す断面図。

【図 3 2】 図 3 1 に続く、本発明の第 2 の実施形態に係わる第 1 の例の半導体装置の製造工程を示す断面図。

【図 3 3】 本発明の第 2 の実施形態に係わる第 2 の例の半導体装置を示す断面図。

【図 3 4】 本発明の第 3 の実施形態に係わる第 1 の例の半導体装置を示す断面図。

【図 3 5】 本発明の第 3 の実施形態に係わる第 1 の例の半導体装置の製造工程を示す断面図。

【図 3 6】 図 3 5 に続く、本発明の第 3 の実施形態に係わる第 1 の例の半導体装置の製造工程を示す断面図。

【図 3 7】 本発明の第 3 の実施形態に係わる第 2 の例の半導体装置を示す断面図。

【図 3 8】 本発明の各実施形態に係わる順テーパーが形成された半導体装置を示す断面図。

【図 3 9】 本発明の各実施形態に係わる順テーパーが形成された半導体装置を示す断面図。

【図 4 0】 本発明の各実施形態に係わる順テーパーとファセットとが形成された半導体装置を示す断面図。

【図 4 1】 従来技術による半導体装置の製造工程を示す断面図。

【図 4 2】 図 4 1 に続く、従来技術による半導体装置の製造工程を示す断面図。

【図 4 3】 図 4 2 に続く、従来技術による半導体装置の製造工程を示す断面図。

【図 4 4】 図 4 3 に続く、従来技術による半導体装置の製造工程を示す断面図。

【図 4 5】 図 4 4 に続く、従来技術による半導体装置の製造工程を示す断面図。

【図 4 6】 図 4 5 に続く、従来技術による半導体装置の製造工程を示す断面図。

【図 4 7】 図 4 6 に続く、従来技術による半導体装置の製造工程を示す断面図。

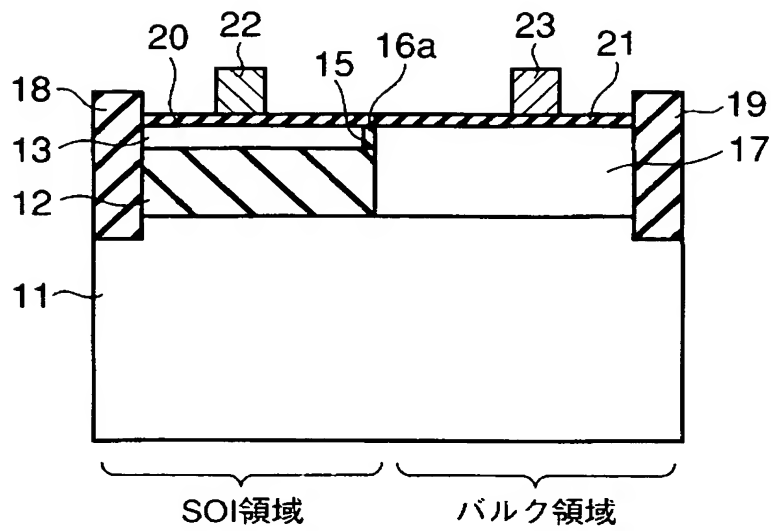
【符号の説明】

1 1…支持基板、1 2, 1 2', 1 2 a…埋め込み絶縁膜、1 3, 1 3 a…S O I 層、1 4…第 1 のマスク材、1 5, 3 5…隙間部、1 6…第 2 のマスク材、1 6 a, 1 8, 1 9, 3 0, 4 0, 4 1, 4 2, 5 0, 5 1, 5 2, 5 5…素子分離領域、1 7…エピタキシャル層、1 2 b, 1 2 c, 2 0, 2 1…ゲート絶縁膜、2 2, 2 3, 3 1, 4 5, 4 6, 5 3 a, 5 4, 5 6…ゲート電極、2 5…

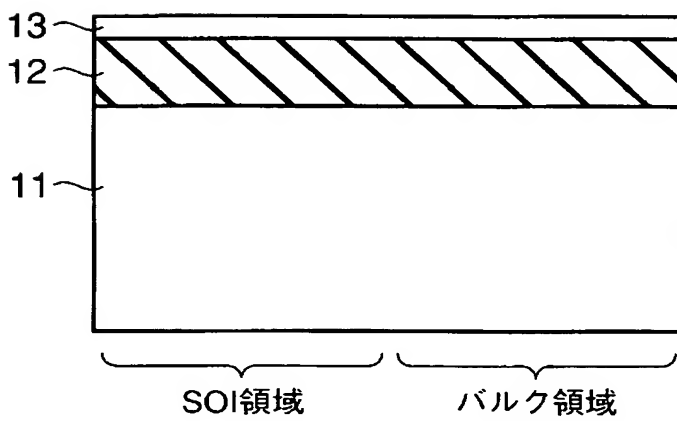
レジスト、2 6…ファセット、4 3, 4 4, 5 3…電極材、1 3 b, 1 3 c, 4 3 a, 4 3 b…下部電極層、4 4 a, 4 4 b, 5 3 b, 5 3 c…上部電極層、2 0 b, 4 7…絶縁膜、4 8, 4 9…凹部、6 2…順テーパー面。

【書類名】 図面

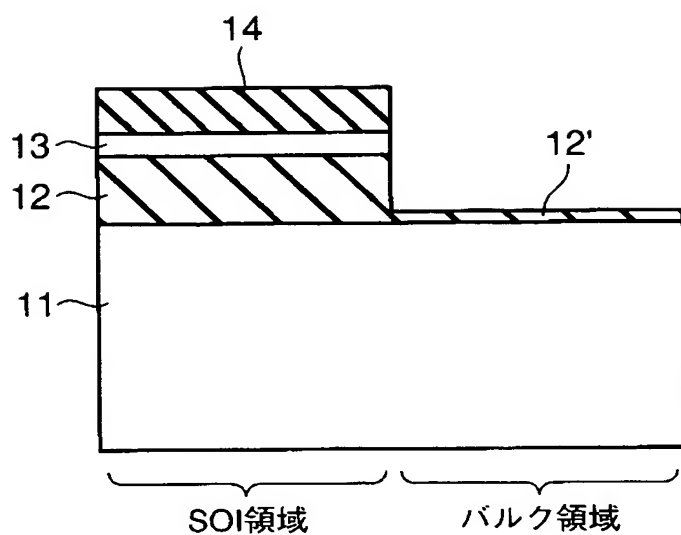
【図 1】



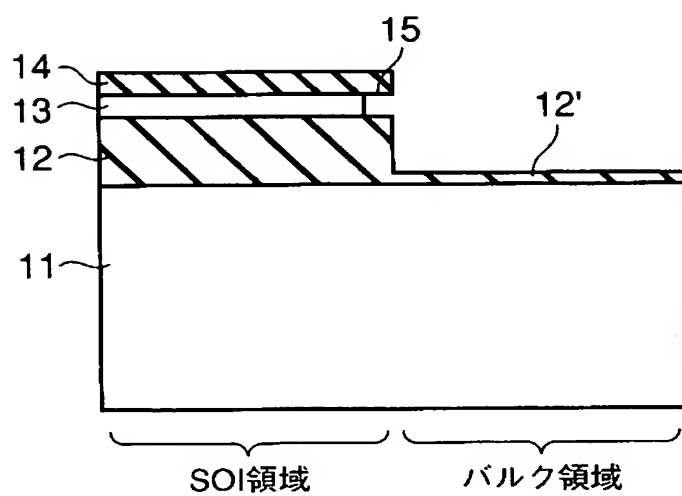
【図 2】



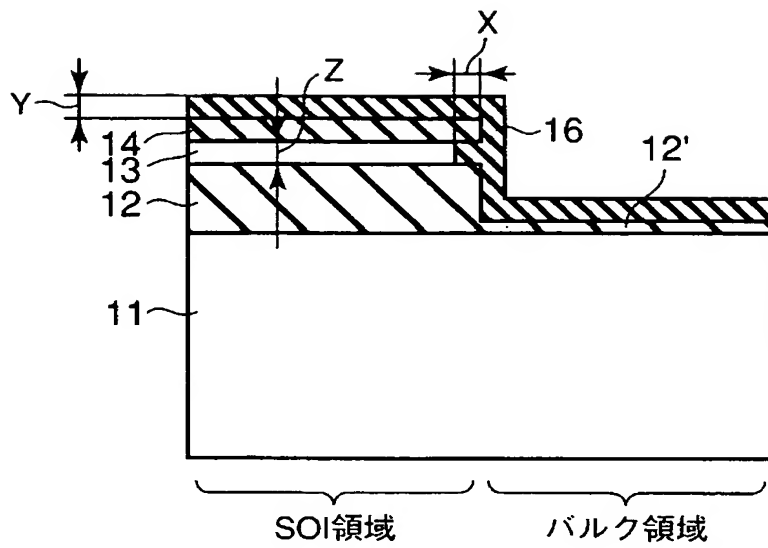
【図 3】



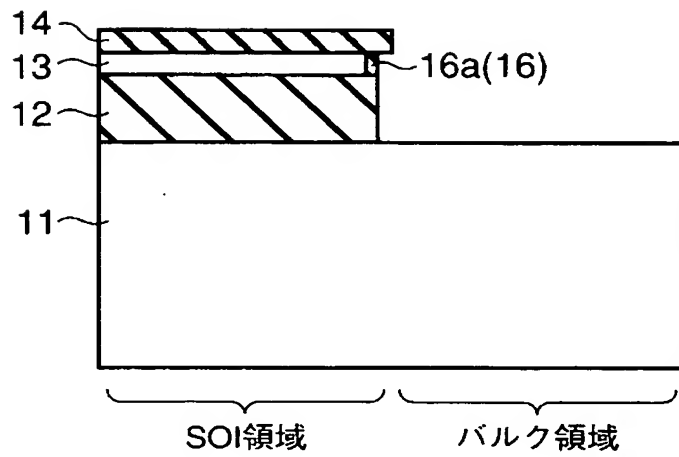
【図 4】



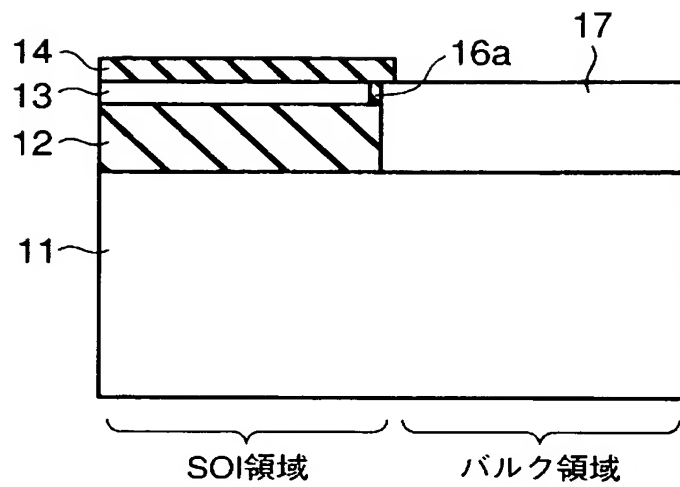
【図 5】



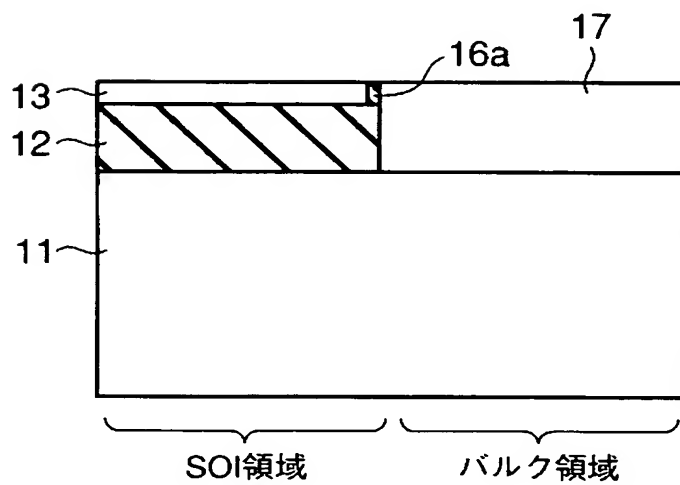
【図 6】



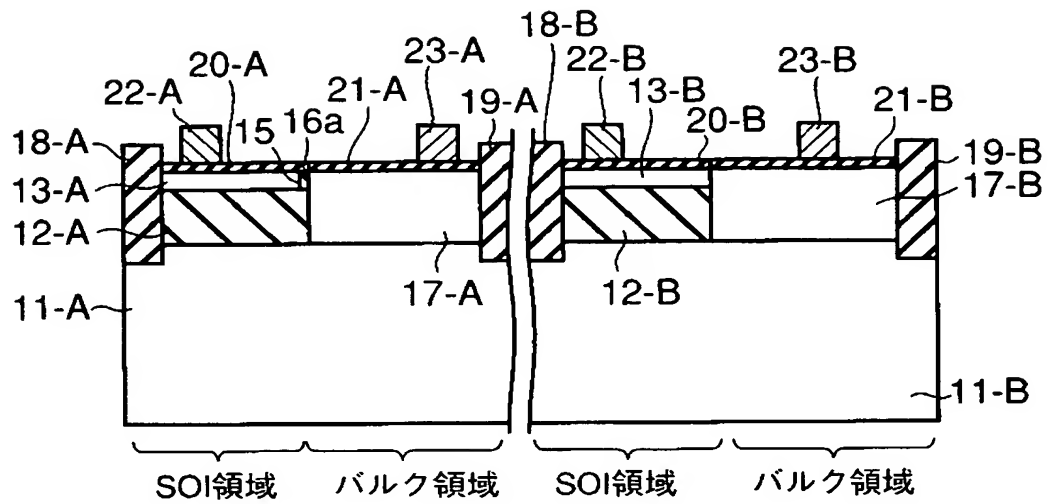
【図 7】



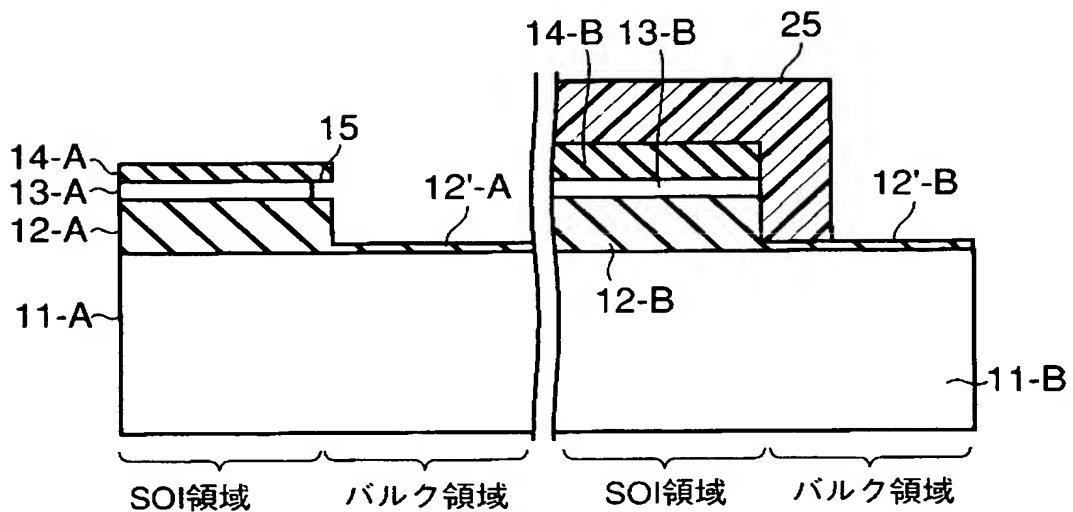
【図 8】



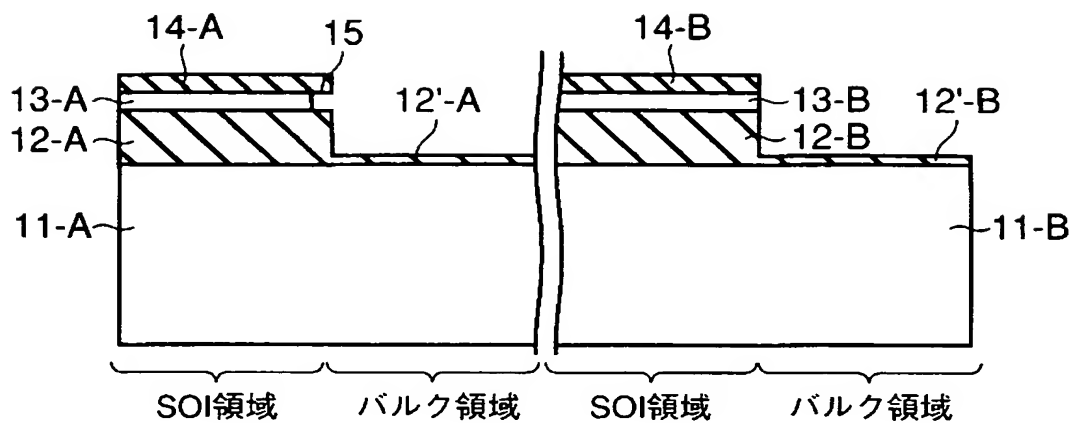
【図 9】



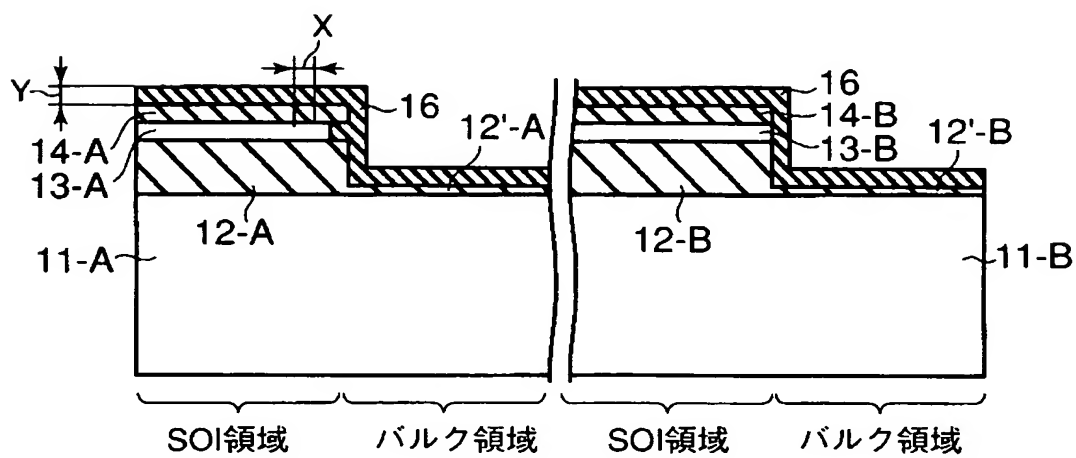
【図 10】



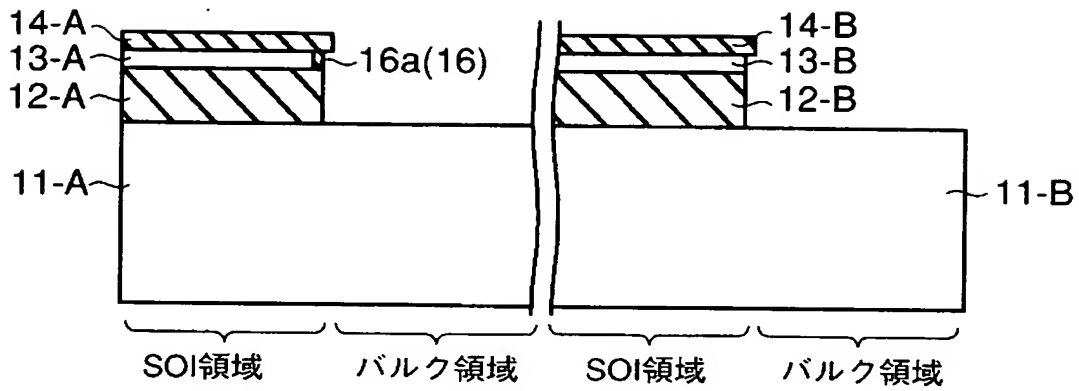
【図 1 1】



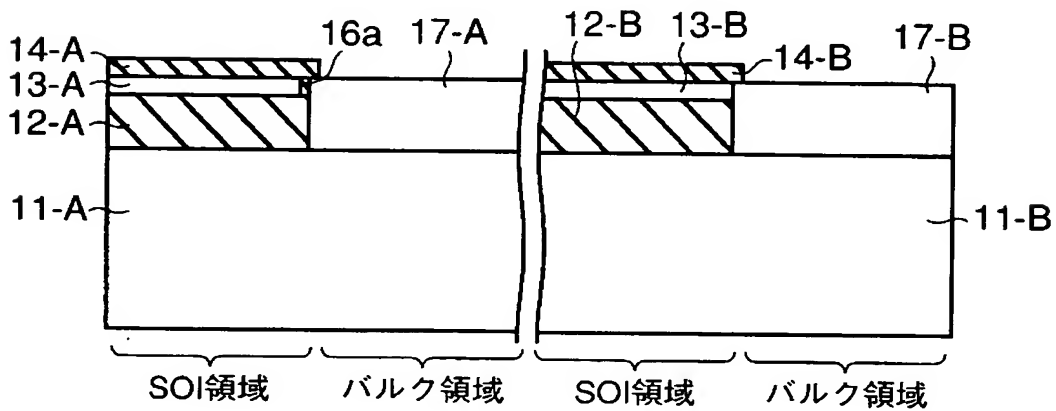
【図 1 2】



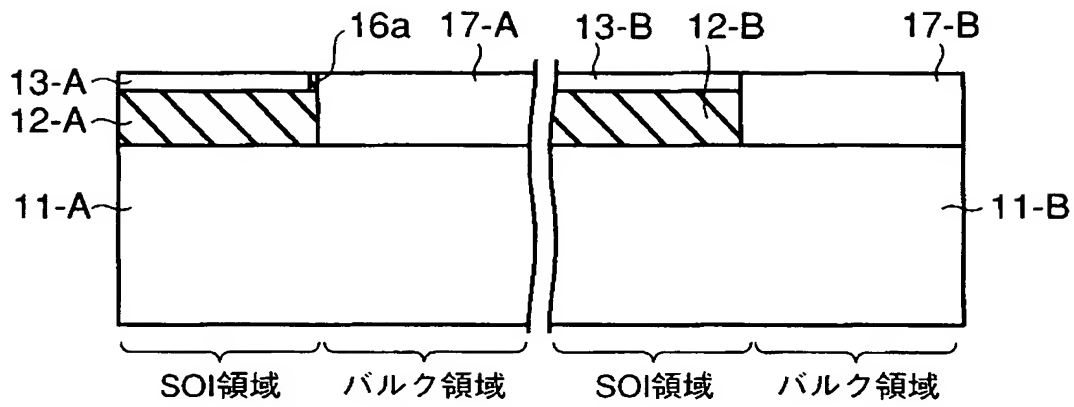
【図 13】



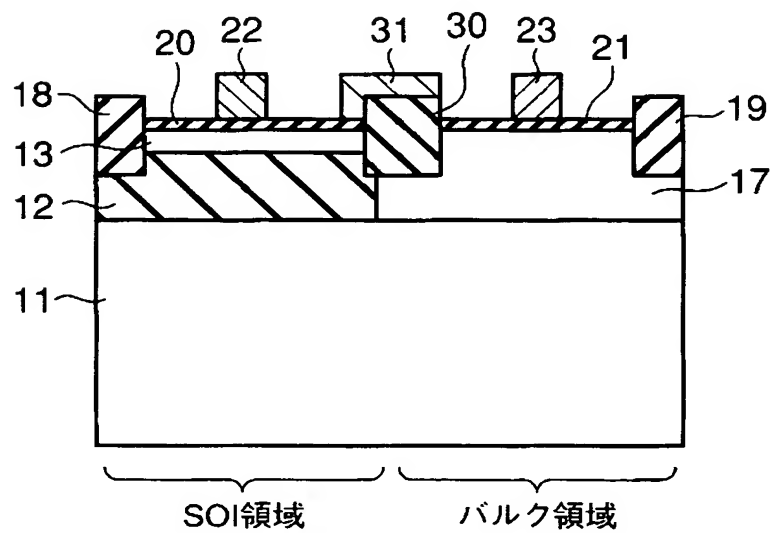
【図 14】



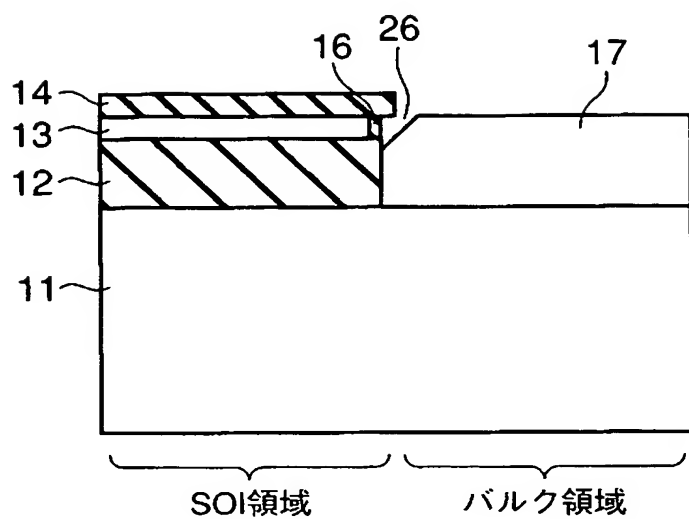
【図 15】



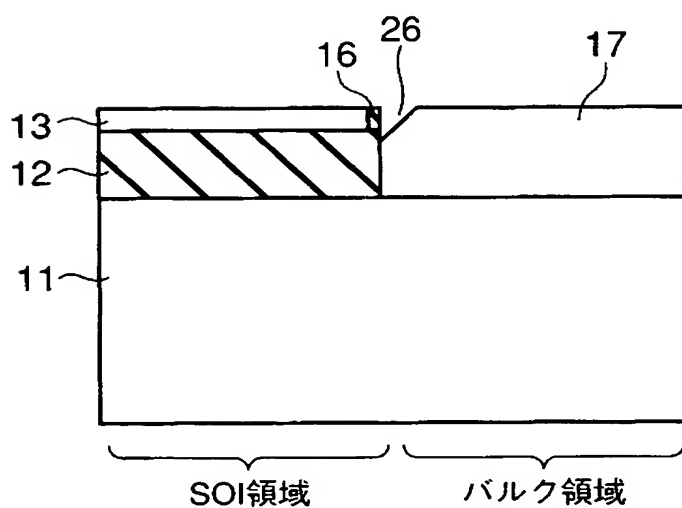
【図 16】



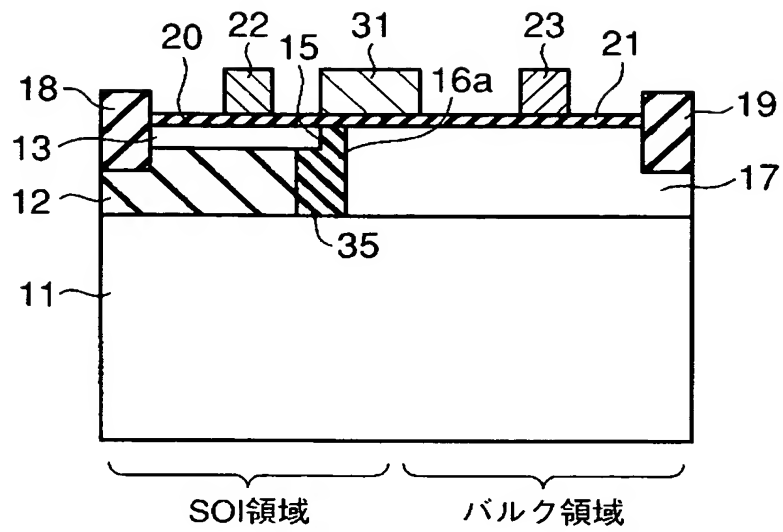
【図 17】



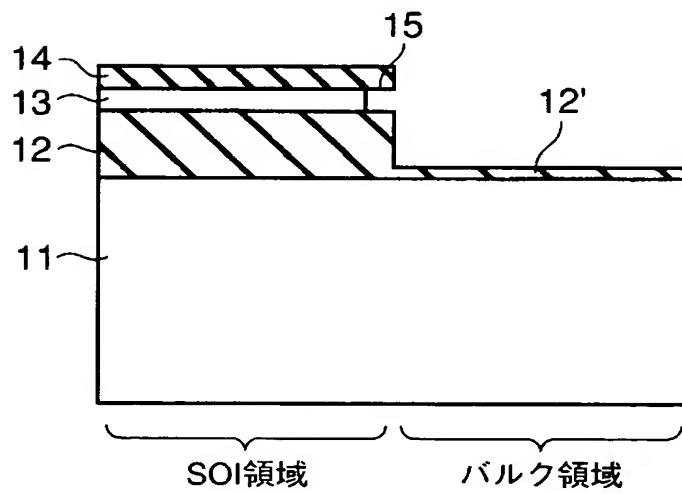
【図 18】



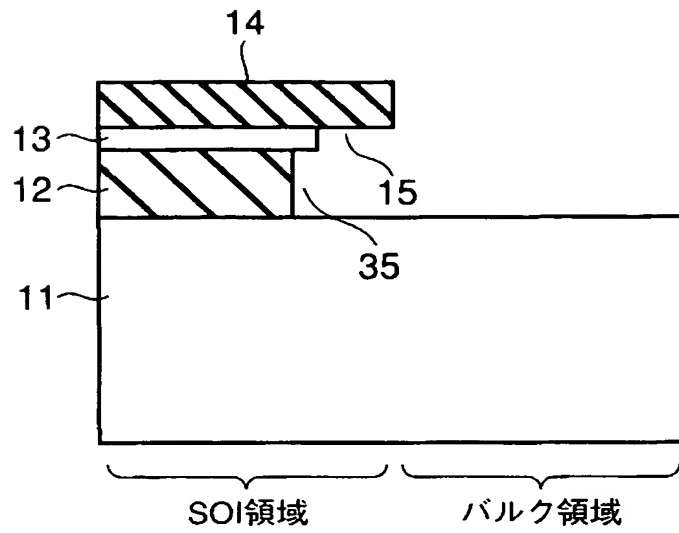
【図 19】



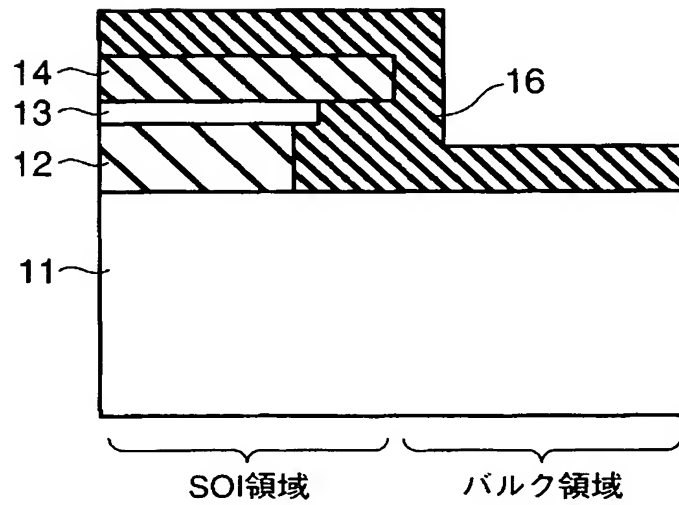
【図 20】



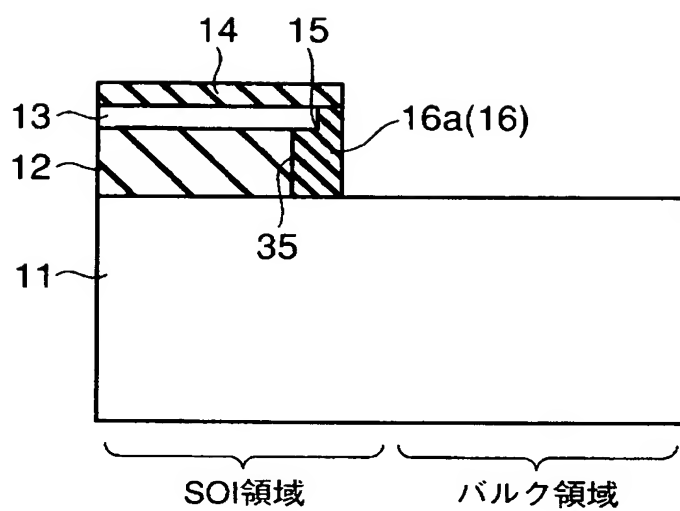
【図 2 1】



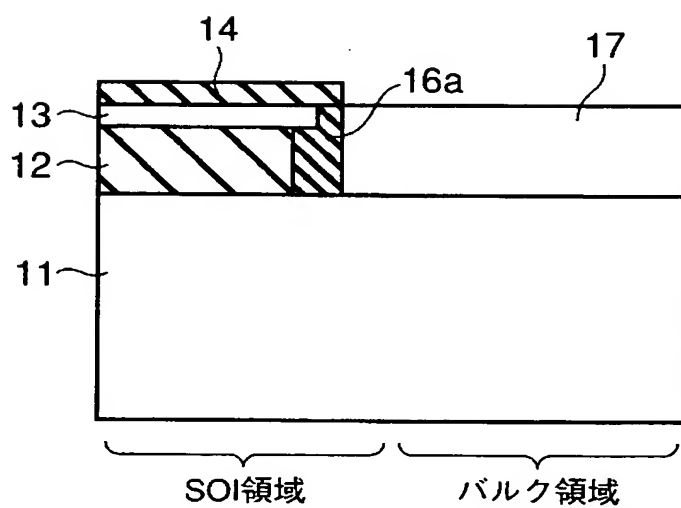
【図 2 2】



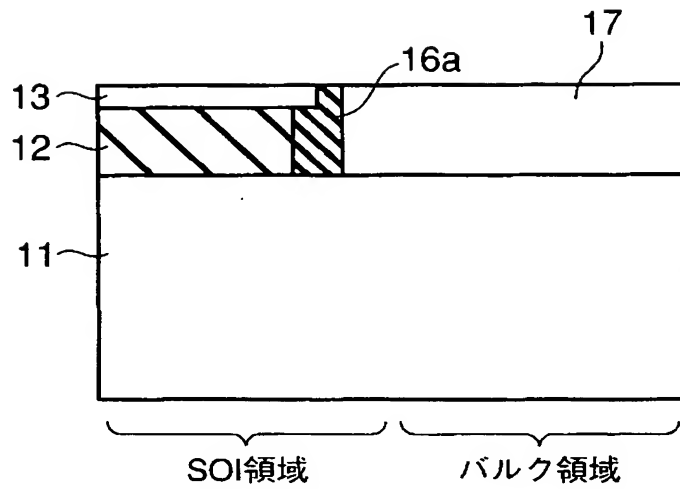
【図 23】



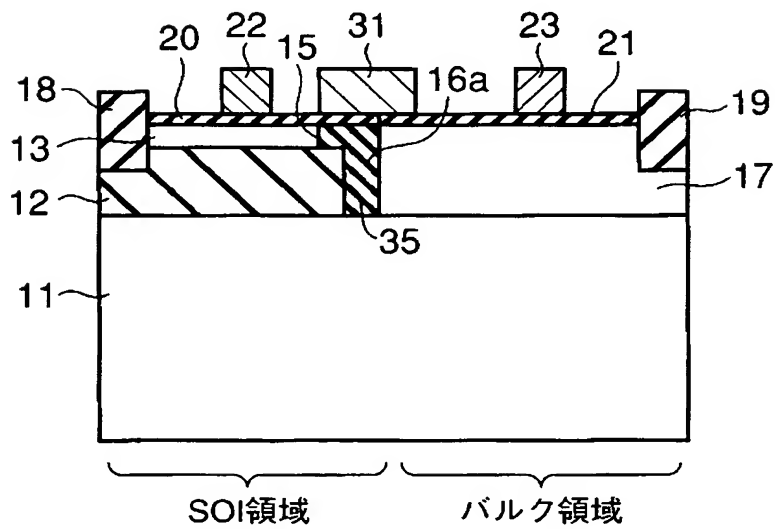
【図 24】



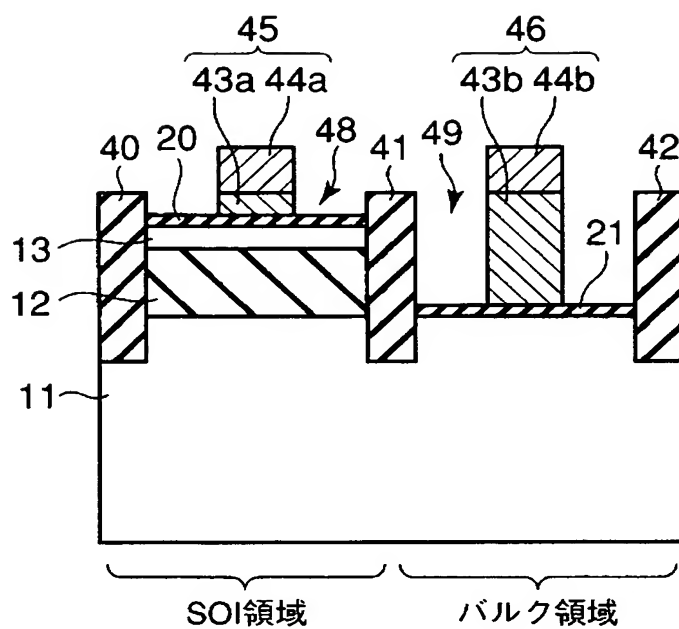
【図 25】



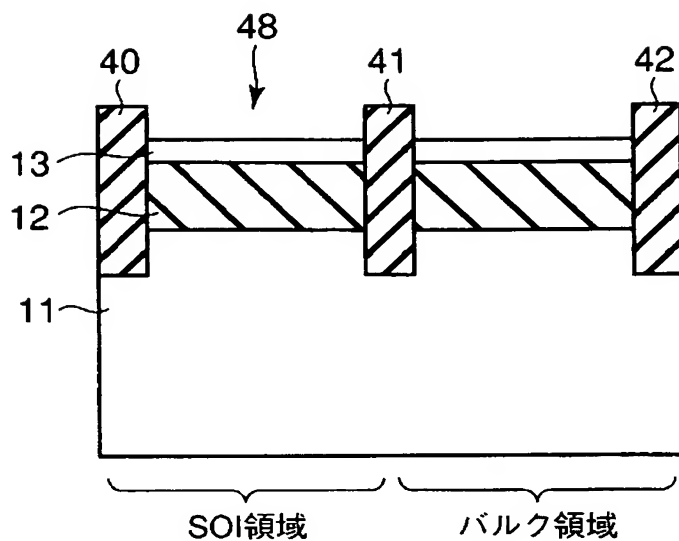
【図 26】



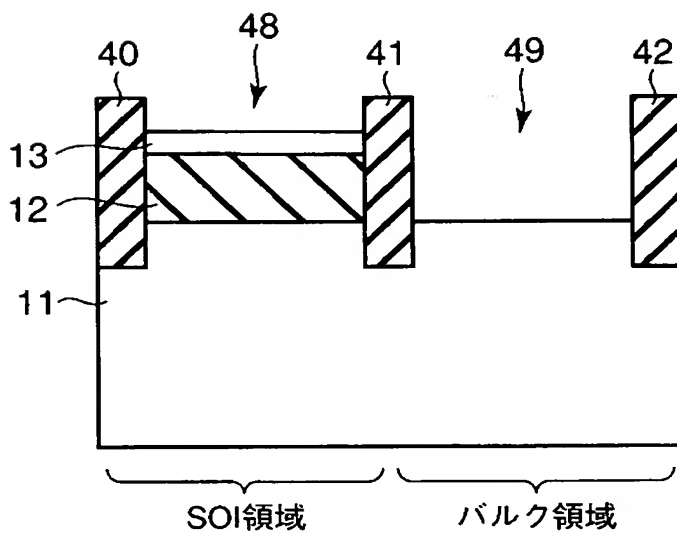
【図 27】



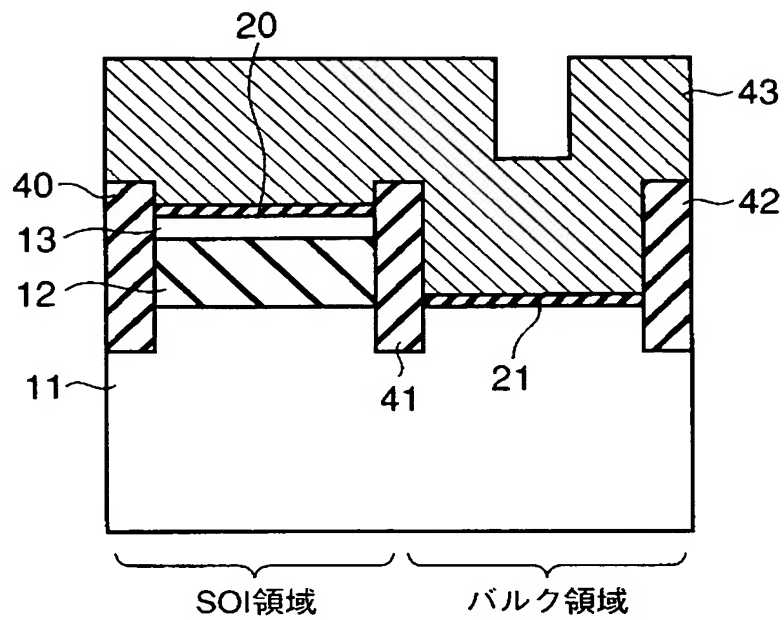
【図 28】



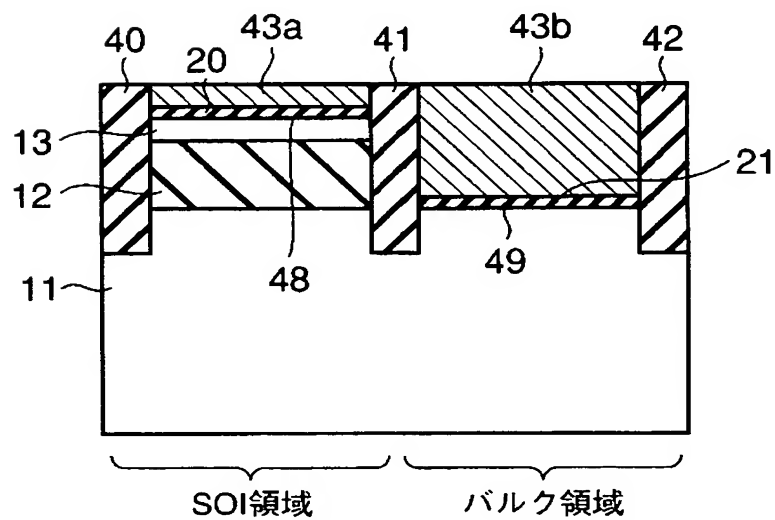
【図 29】



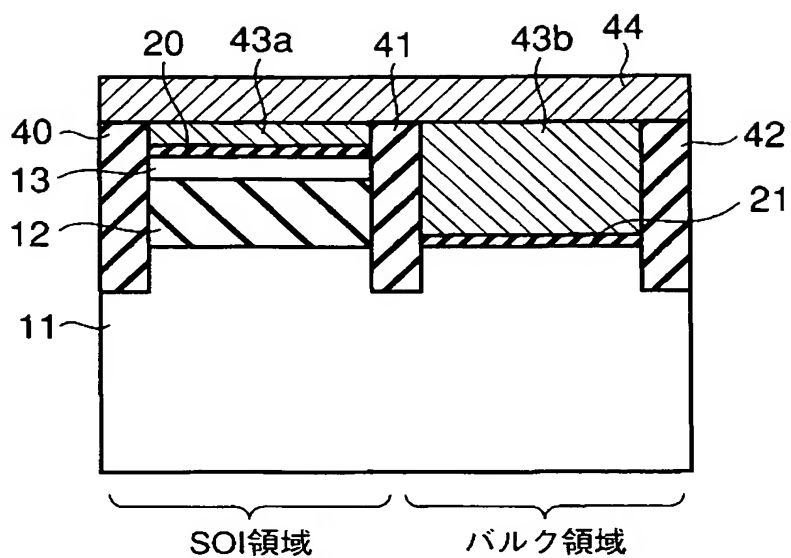
【図 30】



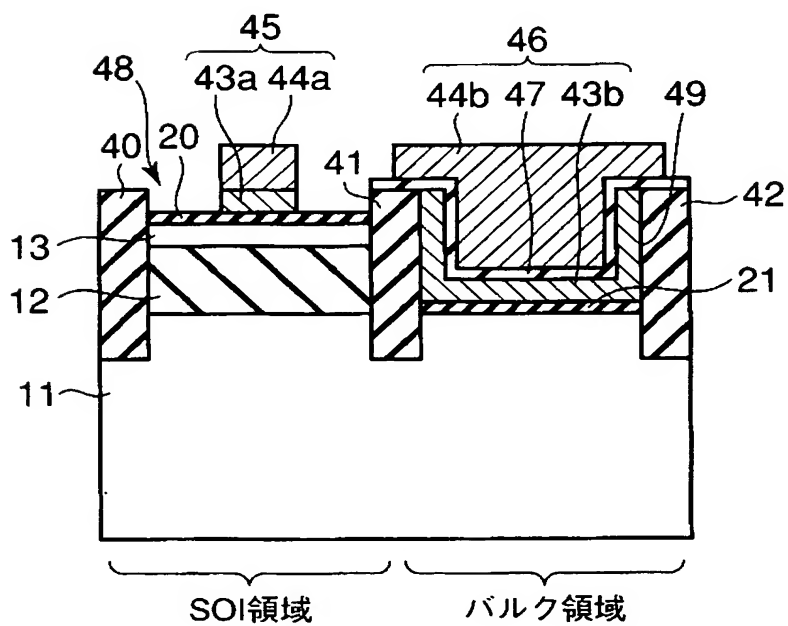
【図 31】



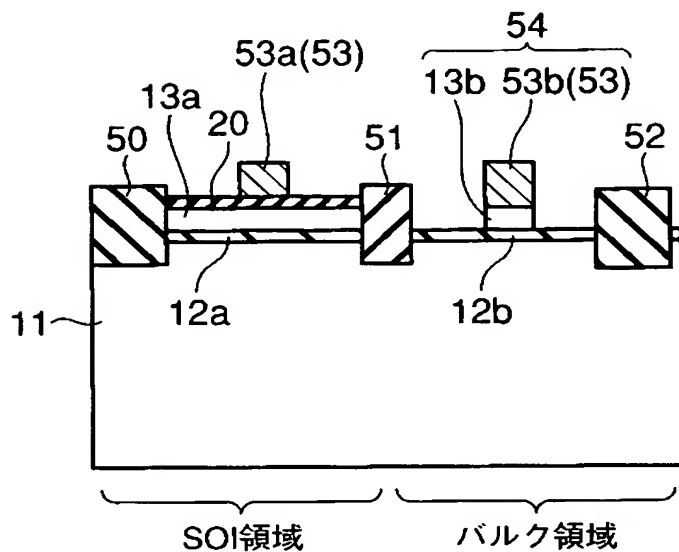
【図 3 2】



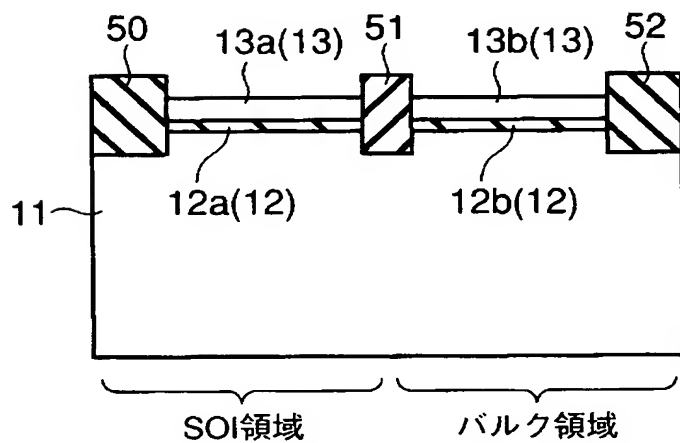
【図 3 3】



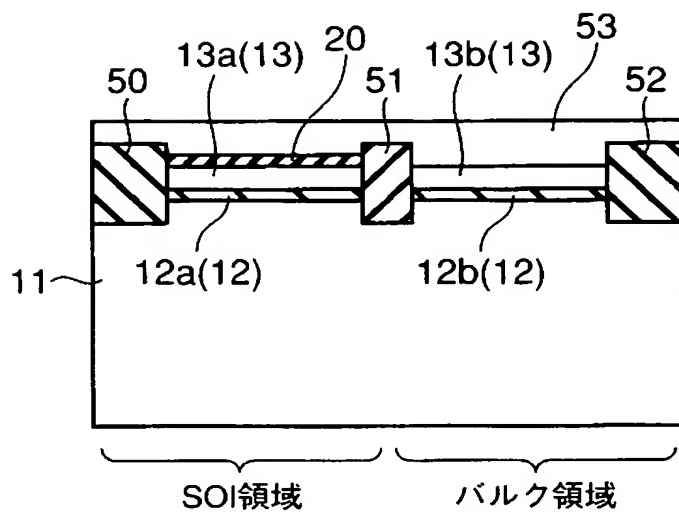
【図 3 4】



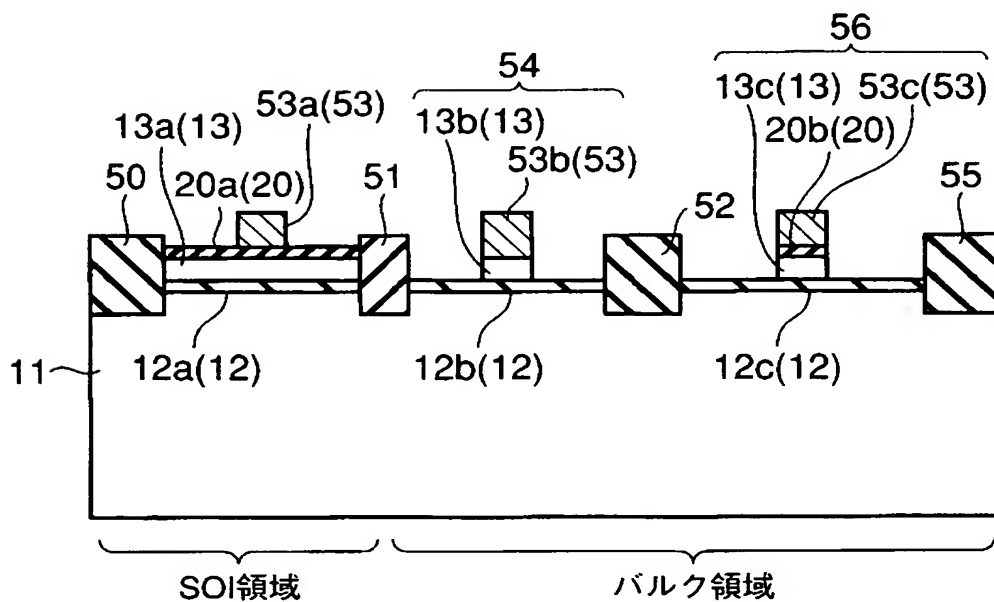
【図 3 5】



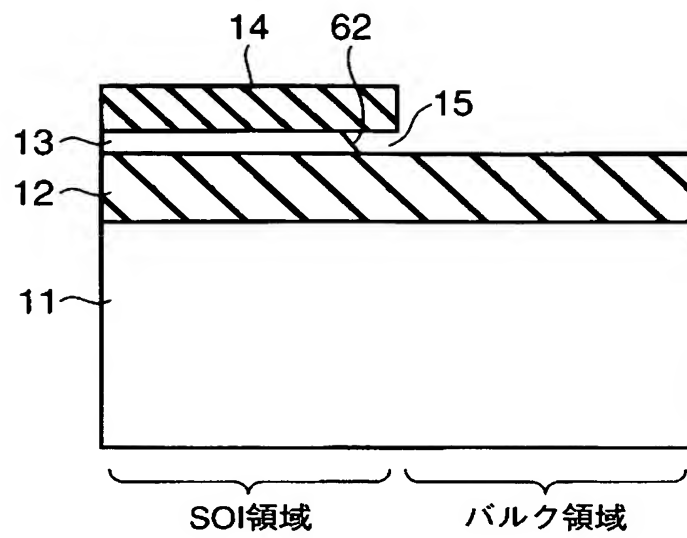
【図 3 6】



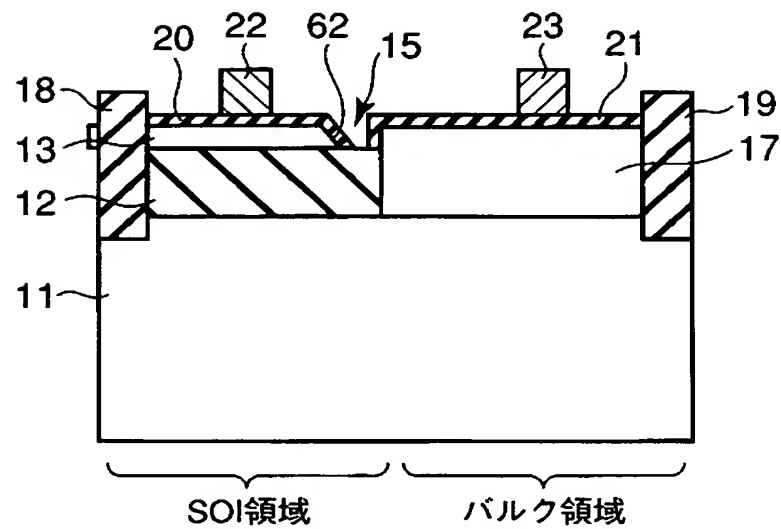
【図 3 7】



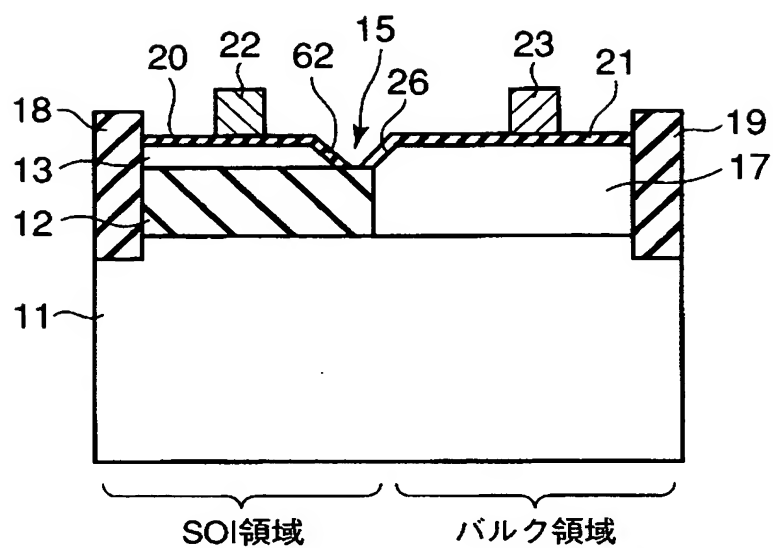
【図 38】



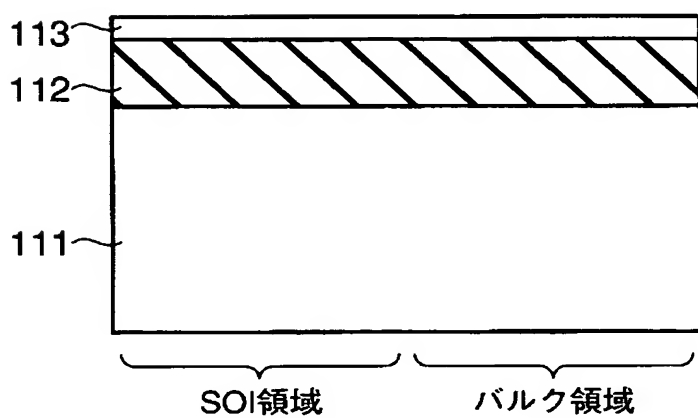
【図 39】



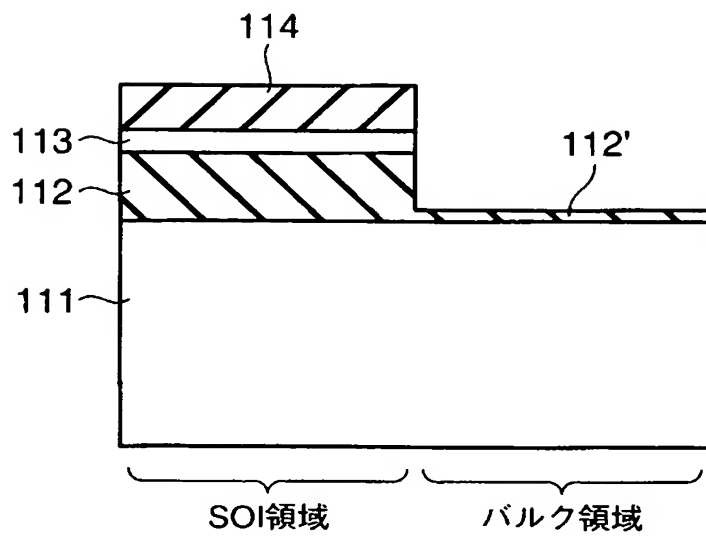
【図 40】



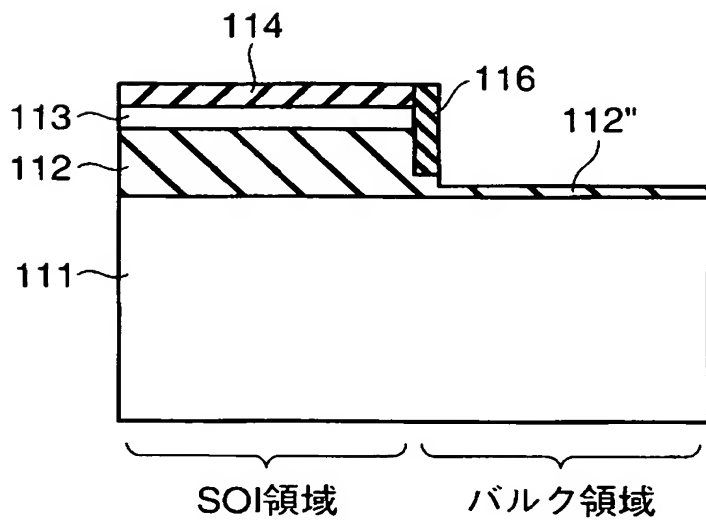
【図 41】



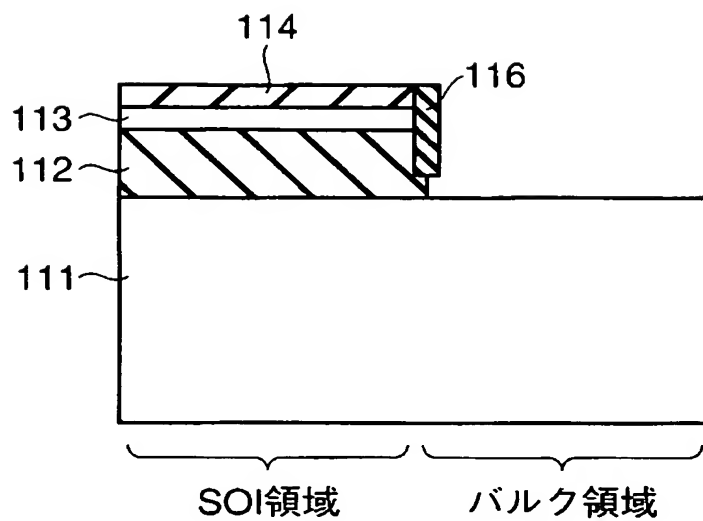
【図 4 2】



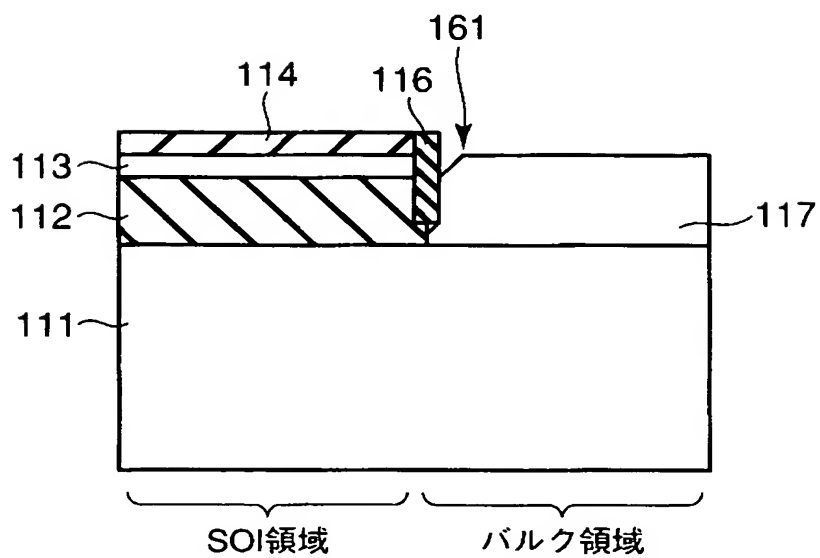
【図 4 3】



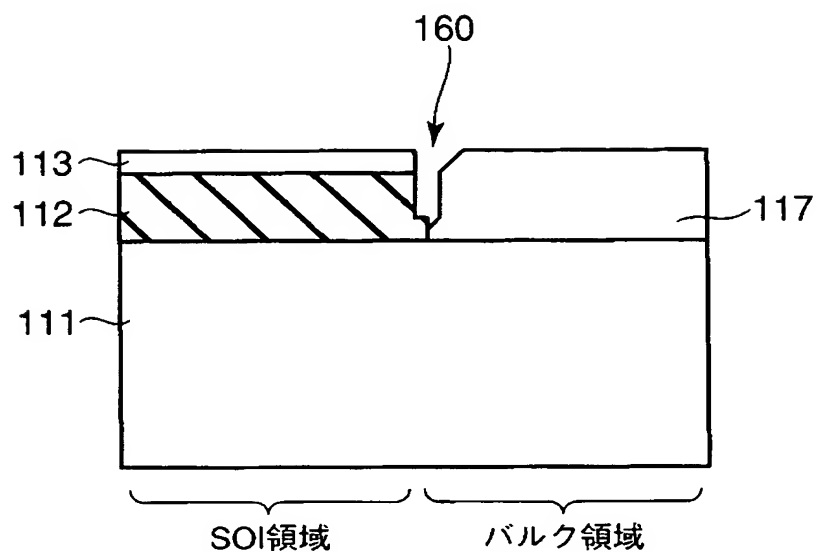
【図 4 4】



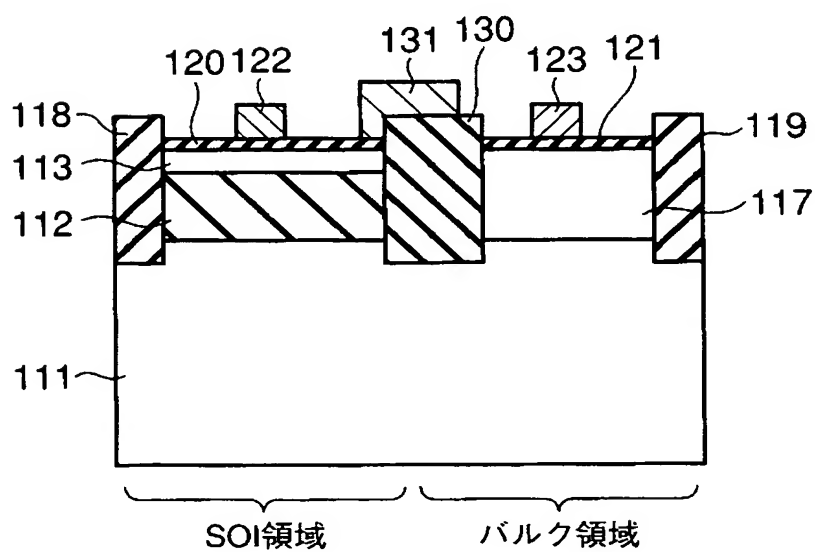
【図 4 5】



【図 4 6】



【図 4 7】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 S O I 領域とバルク領域との境界部における素子分離領域のスペースを縮小する。

【解決手段】 半導体装置は、S O I 領域とバルク領域とを有する基板 1 1 と、S O I 領域における基板 1 1 上に設けられた第 1 の絶縁膜 1 2 と、バルク領域における基板 1 1 上に設けられ、第 1 の絶縁膜 1 2 の上面よりも高い上面を有するエピタキシャル層 1 7 と、このエピタキシャル層 1 7 と隙間を有して第 1 の絶縁膜 1 2 上に設けられ、エピタキシャル層 1 7 の上面とほぼ等しい高さの上面を有する半導体層 1 3 と、前記隙間に設けられ、エピタキシャル層 1 7 の上面及び半導体層 1 3 の上面とほぼ等しい高さの上面を有する素子分離絶縁膜 1 6 a とを具備する。

【選択図】 図 1

特願 2 0 0 3 - 2 0 9 3 1 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 3 0 7 8]

1 . 変更年月日

2 0 0 1 年 7 月 2 日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都港区芝浦一丁目 1 番 1 号

氏 名

株式会社東芝